レーザーと 先端光源加速器

1 はじめに

近年、光源加速器の、とくにその性能を決める基本的なシステムに、レーザーの技術が利用されるようになってきている。既に、RF空洞、電子源、電磁石、真空、モニターなどと並んで、加速器における 基盤技術の一つと言っても良いであろう。

しかし一方で、加速器の分野に関わる多くの人に は、レーザーはあまり馴染みの無いもの(で、危険 なので近づかない方が良いもの)と思われているよ うでもある。これまでのOHOセミナーでもほとん ど扱われて来なかった。今回、ドライブレーザー関 係、というお題で講義の依頼を受けた。ドライブと は何の事やら分からないながらも、ERLや先端光源 加速器で登場するレーザーについて、広く浅く、解 説をすることにした。

加速器の分野に足を突っ込んでいるが、レーザー を専門にしている訳ではない方を念頭にして、打ち 合わせや研究会で出くわす話を理解しようとする際 のとっかかりになる解説にでもなればと思う。加速 器と関係無くレーザーの専門書は沢山のものがある ので、正確で詳細な理解には、それらを参考にして 頂きたい。

本講義では、まず基本に立ち返って、レーザーの原 理について最低限の説明をする。その後、光源加速 器での応用例として、電子銃のフォトカソード、シー ド FEL などのビームの変調、コンプトン散乱、につ いて紹介する。(ビームモニターでのレーザーの利用 も重要であるが、ドライブではないかなと思い、今 回は除外した。)

2 レーザーの原理

そもそもレーザーとは、誘導放出による光増幅作 用 (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) である。ただ、現状では増幅作用のこと だけでなく、その結果生成されるコヒーレントな光 ビームのことをレーザー光またはレーザーと呼ぶよ うになっている。ともかく、誘導放出とはどういう ものか、について説明しなければ話が始まらない。

大抵のレーザーの教科書は、誘導放出ありきで解 説が始まる。おかげで理解した気にならないもので ある。誘導放出は量子力学的な現象で、そこから話 を始めては読者が付いて来ないからであろうか。か といって、量子力学の教科書では、最後の方に申し 訳程度に書かれていることが多く、そこまで飽きず に付いて来る読者もそんなにいない。というわけで、 原理をあまり良く勉強しないままレーザーを扱うこ とになりがちである。せっかくの機会なので、でき るだけ最短距離で原理から考えてみたい。

2.1 量子力学の復習

できるだけ前提とする知識無しに解説するため、 量子力学の解説から始める。

2.1.1 波動性と粒子性

KEK では最近、コンパクト ERL(cERL) という 試験加速器を建設した。cERL は、その利用研究に 向けた一面として、レーザーコンプトン光源 (LCSS: Laser Compton Scattering Source) 試験加速器とし ての位置づけもあるようである。そこで、cERL の 周回部にレーザー蓄積共振器なるものを設置した。

LCSS は、電子ビームとレーザー光を相互作用さ せて短波長の光を生成しようというもので、高強度 の光源を実現するには強いレーザー光が必要である。 レーザー蓄積共振器というものは、加速空洞でおな じみのマイクロ波空洞をレーザー光の波長で作った



図 1: LCSS のセットアップ

ものである。マイクロ波と同じく光も電磁波、つま り波動なので、波の干渉の性質があり、ある閉じた 空間に波を重ね合わせていくことが出来る。蓄積共 振器は、この性質を応用して、もともとのレーザー 光源よりはるかに大きな振幅の電磁波を生成する装 置である。

さて、この共振器に蓄積された、波動であるとこ ろのレーザー光に、ERL 周回中の電子ビームを衝突 させてみた (図 1)。ビーム軸の前方に置かれた検出 器の信号を見ていると、ある決まったエネルギーの 信号がパラパラと観測された。エネルギーが粒子状 に塊になったものが生成しているようである。レー ザー光の強度を変えてみると、信号の頻度が変わる だけで、エネルギーの単位は一定である。何かエネ ルギーの粒子のようなものが、ビーム中の電子に跳 ね飛ばされて出てきていると思われる現象である。 どうやら、光は、波でありながら粒子のような側面 も持っているらしい。

LCSS で単色の X 線が生成されたので、これを手 近な物質に当ててみた (図 2)。今度は検出器を横に置 き X 線が照射された物質から続いて出て来る信号を 観測したところ、当てた X 線よりも低いエネルギー で、いくつかの決まったエネルギーの信号が見られ た。物質を変えると、それぞれの原子組成に応じた エネルギーの信号が出て来るようである。原子とい うものは特定のエネルギー構造のようなものを持っ ているらしい。

加速器を周回していることから、電子は疑いなく



図 2: XRF のセットアップ

電荷を持った粒子である。原子は正電荷の原子核の 周りを負電荷の電子が回っているようなものだと考 えると、特定のエネルギーというものは無さそうに 思える。もし、電子が波のような性質を持つもので あって、原子核にまとわりついた定在波として存在 すると考えると、状態が離散的になり、従って離散 的なエネルギー構造が出来てもおかしく無いかもし れない。

光は波動であって粒子でもあり、電子は粒子であっ て波動でもあるような、考え方をする必要がありそ うである。

2.1.2 数学的準備

厳密な議論をしているふりをするために、最初に 数学的な準備をする。量子力学をユニタリー空間で展 開するが、そのためにまず、実数とは何かを示し、計 量ベクトル空間の概念を示す必要があるからである。

可換群 二項演算が定義された集合で、その二項演 算(+)が次の条件を満たすとき、群とよぶ。

結合則
$$a + (b + c) = (a + b) + c$$
 (1)

零元の存在
$$a+0=0+a$$
 (2)

逆元の存在
$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$
 (3)

さらに

交換則
$$a+b=b+a$$
 (4)

も満たすとき、可換群と呼ぶ。

a,*b*,*c*は任意の元である。

単系 二項演算が定義された集合で、その二項演算 (.) が次の条件を満たすとき、単系とよぶ。

結合則
$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$
 (5)

単位元の存在
$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$
 (6)

体 加法と乗法という2つの二項演算が定義された 集合で、次の条件を満たすとき、体とよぶ。

加法に関して可換群 である (7)

分配則
$$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$
 (9)

自明でない
$$0 \neq 1$$
 (10)

実数の定義 数学的体系として物理法則を記述する には、まず、実数の定義から導入する必要がある。少 し正確に定義すると、

x < y, x = y, x > yの一つだけが必ず成立 (12)

$$x \le y, y \le z$$
ならば $x \le z$ (13)

$$x < y$$
ならば $x + z < y + z$ (14)

$$x < y, 0 < z$$
ならば $x \cdot z < y \cdot z$ (15)

つまり、四則演算が普通に出来て、順序が定義さ れており、連続な集合、が実数体 ℝ である。

なお、この定義を満たす体は実質的に一意である ことが証明できる。このため、通常想像するように、 実数とは数直線上に連続に無限個の数字が並んだも のと考えておけば良い。

複素数の定義 複素数体 C は、実数から定義するこ とができる。つまり、実数の順序対 (*a*, *b*) として定 義し、和と積を、

和 (a,b) + (c,d) = (a+c,b+d) (17)

積
$$(a,b) \times (c,d) = (ac - bd, ad + bc)$$
 (18)

と定める。通常、a + biと書く。a + biの複素共役 を $\overline{a + bi} = a - bi$ と書く。 ベクトル空間 最初に線形代数の復習をし、ユニタ リー空間(計量が定義されたベクトル空間)で枠組み を与えることにする。ベクトル空間とは、足し算と スカラー倍が定義された集合である。つまり、ベク トル空間に属する2つの要素*u*,*v*からもう一つの要 素*w*を作る和という演算があること、要素*v*を*a* 倍に拡大するスカラー倍という演算があること、で ある。厳密には、以下の公理を満たすように定義さ れる。

結合律 u + (v + w) = (u + v) + w (19)

交換律 u + v = v + u (20)

単位元の存在
$$v + 0 = v$$
 (21)

逆元の存在
$$v + (-v) = 0$$
 (22)

分配律
$$a(\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}) = a\boldsymbol{v} + a\boldsymbol{u}$$
 (23)

和の分配律
$$(a+b)\mathbf{v} = a\mathbf{v} + b\mathbf{v}$$
 (24)

- スカラー積の分配律 a(bv) = (ab)v (25)
- スカラー積の単位元の存在 1v = v (26)

計量ベクトル空間 ベクトル空間に内積という演算 を追加したものを、計量ベクトル空間と言う。内積 は要素の大きさや方向のような概念で、要素u, vに たいして、スカラー $\langle u | v \rangle$ を与えるものである。内 積は、以下の公理を満足するものと定義する。

共役対称性 $\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle = \overline{\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{u} \rangle}$ (27)

線形性
$$\langle a\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} | \boldsymbol{w} \rangle = a \langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{w} \rangle + \langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{w} \rangle$$
 (28)

正定値性
$$\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{v} \rangle \ge 0$$
 (29)

とくに、複素数体上の計量ベクトル空間はユニタリー 空間と呼ばれる。量子力学をユニタリー空間で記述 できるものとして、以下考える。

ユニタリー空間は、正規直交基底をもつという基本的な性質がある。つまり、互いに内積が0で大きさが1の要素の集合を用いて任意の要素を展開できる。具体的に書くと、 e_i (i = 1, 2, ...)の要素が、

$$\langle \boldsymbol{e_i} | \boldsymbol{e_j} \rangle = \delta_{ij} \tag{30}$$

を満たし、任意の要素 x が、

$$\boldsymbol{x} = \sum_{i} \langle \boldsymbol{x} | \boldsymbol{e}_{i} \rangle \boldsymbol{e}_{i} \tag{31}$$

と表される。

2.1.3 量子力学の法則

状態の記述 物理法則が次のようになっていると考 える。任意の物理状態 (世界) はユニタリー空間の1 要素として表される。つまり、 ϕ とか χ とかいうも のの一つが今の世界を表す。そして、 ϕ という状態 が χ という状態に観測される確率は、それらの内積 の大きさの2乗 $|\langle \chi | \phi \rangle |^2$ に比例する。

ユニタリー空間の性質から、世界を記述する正規 直交基底 e_i (i = 1, 2, ...)を選ぶことが出来、状態 ϕ は、正規直交基底で展開できる。展開する際の係数 (振幅) C_i を、

$$C_i = \langle \boldsymbol{e_i} | \boldsymbol{\phi} \rangle$$
 (32)

とすると、

$$\phi = \sum_{i} C_{i} \boldsymbol{e}_{i} \tag{33}$$

と書けるということである。結局は、*C_i* (i=1,2,...) の組を指定することが状態を記述することになる。 正規直交基底の選び方はいくらでもあって、もちろ んそれによって係数は異なって表現されるが、実際 の物理状態としては同じものを表すし、物理法則が 変わることは無い。

状態の変化 上述のように状態の記述を与えたので、 次は状態が変化することを記述する必要がある。つ まり、ユニタリー空間のある要素(ある状態)が他の 要素に変化することを表現すれば良い。

観測する際に全ての可能な状態の確率の和は1で あるべきであるから、ある状態から別の状態に変化 する際には大きさを保つような変換のみを扱えば良 い。これはユニタリー演算と呼ばれる変換である。

状態 ϕ にユニタリー演算 A を作用させて状態 χ になる。というのは、

$$\boldsymbol{\chi} = A\boldsymbol{\phi} \tag{34}$$

と書く。正確には、ユニタリー演算は、全射で、任 意の要素 *u*,*v* について内積を保つ演算として定義さ れる。

$$\langle A\boldsymbol{u}|A\boldsymbol{v}\rangle = \langle \boldsymbol{u}|\boldsymbol{v}\rangle$$
 (35)

ユニタリー演算 *A* にたいしてエルミート共役の演 算 *A* というものを、

$$\langle A\boldsymbol{u}|\boldsymbol{v}\rangle = \langle \boldsymbol{u}|A^{\dagger}\boldsymbol{v}\rangle \tag{36}$$

で定義する。とくに、*u*,*v*を基底*ei*に選び、Aを基 底で展開して、

$$A_{ij} = \langle \boldsymbol{e_i} | A \boldsymbol{e_j} \rangle \tag{37}$$

と書くことが出来る。定義から分かるように、ユニ タリー演算は A[†]A = AA[†] = 1の性質がある。また、 とくに A[†] = A となる演算をエルミート演算と呼ぶ。 ユニタリー演算の重要な性質として、任意のユニ

タリー演算 U はエルミート演算 H を用いて

$$U = e^{iH} = 1 + iH + \frac{i^2}{2!}H^2 + \dots$$
(38)

と表すことができることが挙げられる。

結局、状態の変化を記述するということは、作用 を表現するエルミート演算 *H* を求めることに帰着 する。

時間発展 例えば、時間発展による状態の変化について考える。 $\phi(t)$ を時間tでの状態とし、時間がtから $t+\Delta t$ に進む様子は、ユニタリー演算 $U(t+\Delta t,t)$ を用いて、

$$\phi(t + \Delta t) = U(t + \Delta t)\phi(t)$$
(39)

とかける。これを正規直交基底で展開して記述する と、

$$C_i(t + \Delta t) = \sum_j U_{ij}(t + \Delta t)C_j(t) \qquad (40)$$

と書ける。

ユニタリー演算 U_{ij} をエルミート演算 H_{ij} で展開 することが出来るが、 Δt を微小として Δt に関して 1 次までとると、

$$U_{ij} = \delta_{ij} - \frac{i}{\hbar} H_{ij}(t) \Delta t \tag{41}$$

と書ける。(適当な係数 $-i/\hbar$ は、後で便利なように入れてある。) これを使って、

$$\frac{C_i(t+\Delta t) - C_i(t)}{\Delta t} = -\frac{i}{\hbar} \sum_j H_{ij}(t) C_j(t) \quad (42)$$

つまり、

$$i\hbar \frac{dC_i(t)}{dt} = \sum_j H_{ij}(t)C_j(t)$$
(43)

が得られる。正規直交基底で展開した係数 *C_i* の組 の時間変化を記述する微分方程式が得られたことに なる。

2.1.4 状態発展のいくつかの例

1状態系 まず、一番簡単な、基底が1つの場合を 考える。

$$i\hbar \frac{dC_1}{dt} = H_{11}C_1 \tag{44}$$

である。

この微分方程式の解は

$$C_1(t) = ae^{-(i/\hbar)H_{11}t}$$
(45)

である。時間が発展しても形は変わらず、位相だけ が進む。エネルギー E を、時間発展の固有状態の固 有値 (位相の進み方) として定義し、

$$E = H_{11} \tag{46}$$

とする。

2状態系 基底が2つの場合は、

$$i\hbar \frac{dC_1}{dt} = H_{11}C_1 + H_{12}C_2 \tag{47}$$

$$i\hbar \frac{dC_2}{dt} = H_{21}C_1 + H_{22}C_2 \tag{48}$$

と書ける。

2つの基底状態があるといっても、それがほとん ど個別と見なせる場合は、

$$i\hbar \frac{dC_A}{dt} = E_A C_A \tag{49}$$

$$i\hbar \frac{dC_B}{dt} = E_B C_B \tag{50}$$

という独立な1状態系が2つあるだけのものであろ う。この場合は、当然ながら、それぞれの状態に対 応し、エネルギーが E_A と E_B の2つの解がある。

容易に想像できるように、ほぼ独立な2つの状態 があって、その間に摂動的な弱い相互作用がある場 合は、

$$i\hbar \frac{dC_A}{dt} = E_A C_A + \alpha C_B \tag{51}$$

$$i\hbar \frac{dC_B}{dt} = \alpha C_A + E_B C_B \tag{52}$$

となる。 H_{ij} がエルミートであることから、対角項が 位相共役で、また、全体の位相の任意性から、実数と しても一般性を失わない。このため、 $H_{12} = H_{21} = \alpha$ とおいた。 時間に依存した摂動のある2状態系 小さな摂動が あるだけだと考えると、基本的には1状態系の解が 少し変化した表式になるはずである。

$$C_A = \gamma_A e^{-(i/\hbar)E_A t} \tag{53}$$

$$C_B = \gamma_B e^{-(i/\hbar)E_B t} \tag{54}$$

の形に書けるであろう。ここで、 γ_A, γ_B はtの関数 で、ゆっくり変化するものである。

A の状態に観測される確率は、 $|C_A|^2 = |\gamma_A|^2$ 、B の状態に観測される確率は、 $|C_B|^2 = |\gamma_B|^2$ 、という意味である。

これを代入して整理し、

$$\omega_0 = -\frac{E_B - E_A}{\hbar} \tag{55}$$

$$i\hbar \frac{d\gamma_A}{dt} = \alpha \gamma_B e^{-i\omega_0 t} \tag{56}$$

$$i\hbar \frac{d\gamma_B}{dt} = \alpha \gamma_A e^{i\omega_0 t} \tag{57}$$

となる。

ここで、摂動として働く相互作用項が

$$\alpha = 2\alpha_0 \cos(\omega t) = \alpha_0 (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$$
 (58)

の場合を考える。つまり、振動数ωで変化する作用 である。

$$i\hbar \frac{d\gamma_A}{dt} = \alpha_0 (e^{i(\omega+\omega_0)t} + e^{-i(\omega_0-\omega)t})\gamma_B \qquad (59)$$

$$i\hbar \frac{d\gamma_B}{dt} = \alpha_0 (e^{i(\omega-\omega_0)t} + e^{-i(\omega_0+\omega)t})\gamma_A \qquad (60)$$

 $\omega = \omega_0$ の場合を考える。 ω は速い振動とし、速い 振動の項は平均的にはゼロとみなすと、

$$i\hbar \frac{d\gamma_A}{dt} = \alpha_0 \gamma_B \tag{61}$$

$$i\hbar \frac{d\gamma_B}{dt} = \alpha_0 \gamma_A \tag{62}$$

代入してまとめると、

$$\frac{d^2\gamma}{dt^2} = -\left(\frac{\alpha_0}{\hbar}\right)^2\gamma\tag{63}$$

となる。



図 3:2 つの状態の観測確率の時間発展

一般解は、

$$\gamma_A = a \cos\left(\frac{\alpha_0}{\hbar}t\right) + b \sin\left(\frac{\alpha_0}{\hbar}t\right)$$
 (64)

$$\gamma_B = -ia\sin\left(\frac{\alpha_0}{\hbar}t\right) + ib\cos\left(\frac{\alpha_0}{\hbar}t\right) \tag{65}$$

例として a = 1, b = 0の解を考えることにする。 これは、初期状態で状態 A にある場合である。A の 状態に観測される確率 P_A は、

$$P_A = |\gamma_A|^2 = \cos^2\left(\frac{\alpha_0}{\hbar}t\right) \tag{66}$$

B の状態に観測される確率 *P_B* は、

$$P_B = |\gamma_B|^2 = \sin^2\left(\frac{\alpha_0}{\hbar}t\right) \tag{67}$$

となる。はじめ A の状態にあったものが、時間が経 つにつれて B の状態に移って行く (図 3)。つまり、2 つの固有エネルギー状態のエネルギー差に対応する 周波数の摂動を外部から加えると、状態間の遷移が 起こる。また、遷移確率は摂動振幅の自乗に比例す る。ということが結果として得られる。

ここで言う2つの状態が原子のエネルギー準位で、 摂動が光の電場としたとき、入力光によって誘導さ れて量子力学的状態が移り変わる、という現象が説 明できる。つまり、誘導放出や吸収である。

周期的な多状態系 2状態系の説明をしたついでに、 もうすこし話を進めて、多数の状態が一列に並んだ 系を考える。一次元の結晶のような場合である。そ れぞれの状態が独立であれば、

$$i\hbar \frac{dC_n}{dt} = EC_n \tag{68}$$



図 4: 一次元多状態系のエネルギー

で記述される。隣り合う状態との間に僅かな相互作 用 A があるとすると、

$$i\hbar \frac{dC_n}{dt} = -AC_{n-1} + E_0C_n - AC_{n+1}$$
(69)

となる。

$$C_n(t) = \phi(z_n)e^{-(i/\hbar)Et}$$
(70)

と書き、空間的な周期をしとおくと、

$$z_{n+1} = z_n + b \tag{71}$$

と書けることを踏まえて、

$$E\phi(z_n) = -A\phi(z_n-b) + E_0\phi(z_n) - A\phi(z_n+b)$$
(72)

となる。

この方程式は、次の形の解、

$$\phi(z_n) = e^{ikz_n} \tag{73}$$

$$E = E_0 - 2A\cos kb \tag{74}$$

があることが分かる。つまり、波数 k でエネルギー E の進行波解が存在する。 $-1 < \cos kb < 1$ なので、 任意のエネルギーにたいして解がある訳ではないが、 $E_0 - 2A < E < E_0 + 2A$ の範囲には連続的に解が ある (図 4)。もともと、式 68 で記述される 1 つのエ ネルギーしかなかったものが、一列に規則正しく並 んだことによって、連続的なエネルギーをとり得る ようになったということである。

式 74 をエネルギーの最小値付近で展開すると、

$$m = \frac{\hbar^2}{2Ab^2} \tag{75}$$





とおいて、

$$E = \frac{\hbar^2}{2m}k^2 \tag{76}$$

の関係となる。エネルギーと運動量の関係を与える もので、分散関係と呼ばれ、古典力学的には、質量 mの自由粒子の運動を意味する。つまり、隣の状態 との結合(相互作用の大きさAと距離b)が質量を与 え、それに従って、あたかも自由空間にある粒子の ように状態が時間発展する。

運動方程式 周期ポテンシャルの議論を拡張し、離 散化していた距離を無限小に持って行く。 $Ab^2 = m$ を保った状態で、 $b \to 0$ の極限を考えると、

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}C(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}C(x,t)$$
(77)

が得られる。さらに、運動エネルギーと等価なもの としてポテンシャル*V*を導入すると、

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}C(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}C(x,t) + VC(x,t) \quad (78)$$

となる。これを連続空間における粒子の運動を記述 する方程式とする (シュレーディンガー方程式)。

2.1.5 調和振動子

運動方程式が得られたので、連続的な空間におい て、あるポテンシャルに束縛された粒子について考 えてみる。

例として、古典的な調和振動子、つまりバネ定数 $m\omega^2$ のバネに取り付けられた質量 mの質点につい て考えてみる (図 5)。古典的な運動方程式は、

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) + \omega^2 x(t) = 0$$
 (79)

である。あるいは、ポテンシャルが

$$V = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{80}$$

で与えられる系、ということである。

これを量子力学として記述したい。エネルギー固 有状態を考える際には、*C*(*x*,*t*) は時間に依存しない 空間部分と、時間変化する位相部分に分けて書く事 が出来る。

$$C(x,t) = u(x)e^{-(i/\hbar)Et}$$
(81)

式 78 に代入して空間部分だけ書くと次のようになる (時間に依存しないシュレーディンガー方程式)。

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V\right]u(x) = Eu(x) \tag{82}$$

ここで、

$$-i\hbar\frac{d}{dx} = p \tag{83}$$

と書くことにし、

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{i}{m\omega} p \right) \tag{84}$$

という演算子を導入する。簡単に確かめると、

$$aa^{\dagger} - a^{\dagger}a = 1 \tag{85}$$

の関係があることが分かる。これを使って書くと、調 和振動子ポテンシャルの時間に依存しないシュレー ディンガー方程式は、

$$(a^{\dagger}a)u(x) = \left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}\right)u(x) \tag{86}$$

となる。つまり、やりたいことは *a[†]a* の固有値問題 を考えることに他ならないことが分かる。

 $v_n(x)$ を、 $a^{\dagger}a$ の固有値 nの固有状態とする。つまり、

$$(a^{\dagger}a)v_n(x) = nv_n(x) \tag{87}$$

である。このとき、

$$a^{\dagger}a(av_n(x)) = (aa^{\dagger}-1)av_n(x) \qquad (88)$$

$$= a(a^{\dagger}a - 1)v_n(x) \qquad (89)$$

$$= (n-1)(av_n(x))$$
 (90)

また、

$$a^{\dagger}a(a^{\dagger}v_n(x)) = a^{\dagger}(a^{\dagger}a+1)v_n(x) \quad (91)$$

$$= (n+1)(a^{\dagger}v_n(x)) \qquad (92)$$

の関係があることが分かるので、 $av_n(x)$ は、固有値 n-1の固有状態 v_{n-1} 、 $a^{\dagger}v_n(x)$ は、固有値 n+1の 固有状態 v_{n+1} に他ならない。

内積の正定値性から、

$$\langle av_n | av_n \rangle = \langle v_n | a^{\dagger} av_n \rangle = n \langle v_n | v_n \rangle \ge 0$$
(93)

より、固有値 n は負には成り得ない。一方で、a を 作用させるたびに固有値が 1 だけ下がった解をいつ でも作る事が出来る。このことから、 $a^{\dagger}a$ の固有値 は $n = 0, 1, 2, \cdots$ であると結論できる。

式 86 に戻って、調和振動子ポテンシャルのエネル ギー固有値 E_n は、

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega\tag{94}$$

ということになる。

つまり、調和振動子ポテンシャルに束縛された状 態は、エネルギーがとびとびの値になる。また、基底 状態 (n = 0) であっても、零点振動と呼ばれる ħω/2 のエネルギーがあることが分かる。これは調和振動 子に限らず、ポテンシャルに束縛された系で一般に 成り立つことで、例えば、原子核の正電荷のポテン シャルによって束縛された電子についても同様であ る。このことから、原子には離散化されたエネルギー 準位構造があり、そのうちの2つの状態に注目する と、2 状態系の議論が出来ることが分かる。

基底状態 $v_0(x)$ から出発して、固有状態を具体的 に求めることができる。 $v_0(x)$ にたいして、固有値を 1つ下げる演算をするとなくなってしまうので、

$$av_0(x) = 0 \tag{95}$$

の条件が得られる。これをあらわに書き直して整理 すると、

$$\frac{1}{v_0(x)}\frac{d}{dx}v_0(x) = -\alpha^2 x$$
(96)

である。
$$\alpha = \sqrt{m\omega/\hbar}$$
と置いた。この解は、 $v_0(x) \propto e^{-\alpha^2 x^2/2}$ (97)



図 6: 調和振動子ポテンシャルの固有関数

規格化すると、

$$u_0(x) = v_0(x) = \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\right)^{1/2} e^{-\alpha^2 x^2/2}$$
(98)

である。エネルギーが高い解は、これに *a[†]* を作用さ せて作る事ができる。

$$u_{n+1}(x) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} a^{\dagger} u_n(x)$$
(99)

$$u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a^{\dagger})^n u_0(x)$$
 (100)

具体的には、

$$u_n(x) \propto H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$
 (101)

H_n は次数 *n* のエルミート多項式である。これを図 6 に示す。束縛された状態なので、無限遠に行くと ゼロになる関数である。基底状態はガウス型、次数 が上がる毎に節が増える関数になる事が分かる。

2.1.6 電磁場の量子化

次は、光が粒子の側面を持つ事を記述する。

電磁波の基礎方程式は、マクスウェル方程式と呼ば れるもので、4元ベクトル $A_{\mu} = (\phi, A) \ge j_{\mu} = (\rho, j)$ にたいして、

$$\Box^2 A_{\mu} = -\frac{j_{\mu}}{\epsilon_0} \tag{102}$$

および、電荷の保存則

$$\nabla_{\mu} j_{\mu} = 0 \tag{103}$$

である。

もう少し具体的に書くと、

$$\nabla^2 A - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\frac{j}{\epsilon_0 c^2} \tag{104}$$

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{105}$$

ここで、

$$\nabla \cdot A = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} \tag{106}$$

である。 $A をベクトルポテンシャル、<math>\phi$ をスカラー ポテンシャルと呼ぶ。jは電流密度、 ρ は電荷密度で ある。

電場 E と磁場 B は、

$$E = -\nabla\phi - \frac{\partial A}{\partial t} \tag{107}$$

$$B = \nabla \times A \tag{108}$$

で得られる。

とくに真空中 $(j = 0, \rho = 0)$ の場合は、 $E \ge B$ も同じ形になって、

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0 \tag{109}$$

$$\nabla^2 B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0 \tag{110}$$

いずれにせよ、波動方程式

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \qquad (111)$$

を考えることに尽きる。 $\psi(r,t)$ を、モード展開して 表すことにする。時間部分 $q_l(t)$ と空間部分 $u_l(t)$ に 分離して、

$$\psi(r,t) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}} \sum_l q_l(t) u_l(r)$$
(112)

と書く。しはモードを表す。

$$\nabla^2 u_l(r) + \frac{\omega_l^2}{c^2} u_l(r) = 0 \qquad (113)$$

$$\frac{d^2 q_l(t)}{dt^2} + \omega_l^2 q_l(t) = 0 \qquad (114)$$

が得られる。ω_l はモードを特徴づける変数分離の定数である。式 114 は、式 79 に示した古典的調和振動子の運動方程式と全く同じ形である。

ここまでの古典電磁場を量子力学に置き換えるに は、形式的に同じ手続きをすれば良いとする。つまり、

$$\frac{d}{dt}q_l(t) \to -i\hbar \frac{d}{dq} \tag{115}$$

という置き換えを形式的に行う、ということである。 そうすると、同じ形の式から出発したので、当然 おなじ結果が得られて、固有エネルギーが

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_l \tag{116}$$

 $n=0,1,2\cdots$ 、となる。

電磁場のとり得るエネルギーは $\hbar\omega_l$ を単位として とびとびである。つまり、光はエネルギーの粒子の ように記述される。また、n = 0の真空状態も零点 振動の場が存在することが分かる。

2状態系の遷移を考えた際、外部からの摂動によっ て状態が移り変わるとした。もし、摂動が無ければ 永遠に同じ状態にあるということになるが、真空に も零点振動の場があるということなので、これによっ ても状態の遷移が起こる。つまり、入力光に依存し ない遷移、それに伴って状態間のエネルギー差に対 応する光が放出されるという現象である(自然放出)。

2.2 統計力学の復習

現実の世界では、多数の原子からなる系を扱う。 多数の量子力学的状態の平均した分布を制御するこ とでレーザー装置は動作する。統計力学的な扱いが 必要である。

2.2.1 温度

エネルギーが E の閉じた系を考える。系に許され る状態数を W とし、エントロピーと呼ぶ量 S を次 のように定義する。

$$S = k_B \ln W(E) \tag{117}$$

k_Bは、適当なスケール因子である。

仮に、この系が、エネルギーのやりとりが出来る 2つの系から成っているとする (図7)。それぞれの系



 $E = E_1 + E_2$

図 7: エネルギーのやりとりが出来る 2 つの系から なる系

のエネルギーを E_1, E_2 、許される状態数を $W_1(E_1),$ $W_2(E_2)$ とすると、

$$W(E) = \sum_{E_1+E_2=E} W_1(E_1) \times W_2(E_2) \quad (118)$$

~ $W_1(E_1) \times W_2(E_2) \quad (最大の項)$
(119)

である。(非常に多数の状態がある場合は、式118の 和は最大の寄与をする項の付近で鋭いピークになる ので、ほぼその最大の寄与をする項だけで近似する ことができる。)

全ての微視的状態は同じ確率で実現する、という 原理(等重率の原理)に従うものと考えると、実現さ れる巨視的な状態は、微視的な状態数が最大のもの になるはずである。つまり、全体のエネルギー Eを 保存して、全系の状態数が極大をとるときを考える と、2 つの系にどのようにエネルギーが分配された 状態が実現するかが分かる。

$$dW = \frac{\partial W_1}{\partial E_1} W_2 dE_1 + W_1 \frac{\partial W_2}{E_2} dE_2 = 0 \qquad (120)$$

 $dE_1 = -dE_2 なので、$ $1 \partial W_1 \quad 1 \partial W_2$

$$\frac{1}{W_1}\frac{\partial W_1}{\partial E_1} = \frac{1}{W_2}\frac{\partial W_2}{\partial E_2}$$
(121)

あるいは、それぞれの系のエントロピーで書くと、

$$\frac{\partial S_1}{\partial E_1} = \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \tag{122}$$

の状態が実現すると理解できる。

温度 T を、

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} \tag{123}$$

で定義する。つまり、2つの系が平衡状態にあると は、温度が等しいということである。



図 8: 熱浴と平衡状態にある系

2.2.2 ボルツマン分布

ある系が温度*T*にあるとき、エネルギーが*E*の状態の一つが実現する確率はいくらか、という問題を 考える。全体の確率で規格化するので、エネルギー $E_1 \ge E_2$ の微視的状態の実現確率 $P(E_1), P(E_2)$ の 比を考えれば十分である。対象としている系と、そ れより圧倒的に大きな熱浴となる系が温度*T*で熱平 衡状態にあり、全体として閉じた系にあると考える (図 8)。全体のエネルギーを E_t 、熱浴系の状態数を W_b ,エントロピーを S_b とする。確率の比は、熱浴系 の状態数の比になるから、

$$\frac{P(E_2)}{P(E_1)} = \frac{W_b(E_t - E_2)}{W_b(E_t - E_1)}$$
(124)
$$= \exp\left[\frac{S_b(E_t - E_2) - S_b(E_t - E_1)}{k_B}\right]$$
(125)

である。ここで、熱浴に比べて対象としている系は 十分小さいので一次で展開すると、

$$S_b(E_t - E) \sim S_b(E_t) + \frac{\partial S_b}{\partial E}E \quad (126)$$
$$= S_b(E_t) - \frac{E}{T} \quad (127)$$

と表すことができる。これを利用して式 125 は、

$$\frac{P(E_2)}{P(E_1)} = \frac{\exp(-E_2/k_B T)}{\exp(-E_1/k_B T)}$$
(128)

となる。つまり、温度 T のときにエネルギー E の状態の一つが実現する確率 P(E) は、

$$P(E) \sim \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$$
 (129)



図 9: ボルツマン分布に従う原子状態の分布

に比例する (ボルツマン分布)。エネルギーが高い状 態ほど、実現確率が低いということである。たとえ ば、原子にはいくつかエネルギー固有状態があり、多 数の原子がある温度に置かれているとすると、個々 の原子の状態の分布は、ボルツマン分布に従う (図 9)。

2.2.3 電磁波の状態分布

既に述べたように、電磁波は調和振動子の集合と して記述され、そのエネルギーは $\hbar\omega$ を単位として とることが出来る。多数の調和振動子の状態の分布 はボルツマン分布に従うと考えられる。このとき、 調和振動子一つあたりの平均のエネルギー $\langle E \rangle$ を求 める。簡単のため、 $\alpha = e^{-\hbar\omega/k_BT}$ とおく。基底状態 にある個数を N_0 として、n 番目の順位にある振動 子の個数は $N_0\alpha^n$ 、そのエネルギーは $n\hbar\omega N_0\alpha^n$ と なるので、

$$\langle E \rangle = \frac{N_0 \hbar \omega (0\alpha^0 + 1\alpha^1 + 2\alpha^2 + \cdots)}{N_0 (\alpha^0 + \alpha^1 + \alpha^2 + \cdots)} = \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega / k_B T} - 1}$$
(130)
$$E \not \simeq \not \simeq$$

空間には振動数の異なる振動子が無数に分布して おり、その密度は振動数 ω に依存する。 $\langle E \rangle$ に振動 子の密度分布をかけると、温度Tで熱平衡状態にあ る電磁場のエネルギー分布を得る事が出来るはずで ある。

まず、一辺 *L* の立方体を仮定して、状態の個数を 計算する (図 10)。境界条件より、この中の定在波電



図 10: 一辺 L の境界における定在波電磁波モード

磁波モードは、

$$E = \sin\left(\frac{n_x \pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n_z \pi x}{L}\right) \quad (131)$$

の形で書けるものに限られる。ここで、

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \frac{L^2 \omega^2}{\pi^2 c^2}$$
(132)

 $(n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3...)$ である。つまり、モード数 は 3 次元空間の半径 $L\omega/\pi c$ の 1/8 球に含まれる格 子点の数に相当する。電磁場の場合、偏光方向で 2 倍を含めて、モードの個数は、

$$\frac{1}{8}\frac{4\pi}{3}\left(\frac{L\omega}{\pi c}\right)^3 \times 2 \tag{133}$$

単位体積あたりにするには L^3 でわって、単位角周 波数あたりの状態密度 $du/d\omega$ は、

$$\frac{du}{d\omega} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \tag{134}$$

結局、温度*T*における光のエネルギー分布 $I(T, \omega)$ は、平均エネルギーと状態密度をかけて、

$$I(T,\omega) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3 (e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)}$$
(135)

となる。つまり、温度*T* の空間はこのようなエネル ギー分布をもった電磁波 (光子) に満たされていると いうことである (黒体輻射)。

2.3 光増幅の原理

ようやくここで、誘導放出による光増幅が説明で きる。ここまでに議論してきた、2 状態系の遷移と 統計力学による分布が基礎になる。



図 11: 反転分布による光の増幅

光が増幅されることが分かれば、あとは適当に帰 還させれば発振器ができるし、それを種光として増 幅させていけば強力な光が得られることは想像でき るであろう。

2.3.1 2状態系の放射係数

ω だけ離れた 2 つのエネルギー準位がある多数個
 の原子の系を考える。基底状態を準位 1、励起状態
 を準位 2、とする。この系に電磁波が入力される状況を考える (図 11)。

これまでの議論で分かった事をまとめる。まず、 基底状態にある原子は、電磁波を吸収して励起状態 に移ることができる (吸収)。これは、基底状態の原 子数 N_1 と電磁波の強度 $I(\omega)$ に比例する頻度で起こ る。一方、励起状態にある原子は、電磁波の摂動に よって基底状態に遷移する (誘導放出)。これは、励 起状態の原子数 N_2 と電磁波の強度 $I(\omega)$ に比例する 頻度で起こる。さらに、電磁波の強度に依存せずに 基底状態に遷移する場合もある (自然放出)。これは、 励起状態の原子数 N_2 に比例する。

自然放出の係数を A₂₁、誘導放出の係数を B₂₁、吸 収の係数を B₁₂ とおくと、基底状態から励起状態へ 変化する頻度 R₁₂ は、

$$R_{12} = N_1 B_{12} I(\omega) \tag{136}$$

また、励起状態から基底状態へ変化する頻度 R₂₁ は、

$$R_{21} = N_2 [A_{21} + B_{21} I(\omega)] \tag{137}$$

となる。2 状態系の遷移の議論から、 $B_{12} = B_{21}$ であることは分かっている。

出力される電磁波は、誘導放出による増加と、吸 収による減少によって、

$$[1 + (N_2 - N_1)B]I \tag{138}$$

となる。もし、N₂ > N₁ (反転分布) であれば、入力 より出力が大きくなり、光の増幅が起こることにな る。ただし、熱平衡状態においては、ボルツマン分 布で、エネルギーの高い状態ほど少ないはずである。 つまり、通常の熱平衡状態にある系では光の増幅は 起きない。

簡単な考察から、係数A, Bの関係が得られる。こ の系が温度Tで熱平衡状態にあるとすると、 $R_{12} = R_{21}$ の条件になるはずで、これを解くと、

$$I(\omega) = \frac{A}{B(e^{\hbar\omega/k_BT} - 1)}$$
(139)

外部からの光無しに平衡状態にある場合は、*I*(ω) は式 135 の黒体輻射の分布になるはずである。この ことから、2 つの係数 *A*, *B* の間に、

$$\frac{A}{B} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \tag{140}$$

の関係が成り立つ。つまり、自然放出が大きいもの は誘導放出も大きい、という一般則が得られる。

2.3.2 レート方程式

2準位の間に反転分布ができていれば、誘導放出 によって、光の増幅が起こることが分かった。しか し、すでに述べたように反転分布は熱平衡では実現 しない。そこで、外部からエネルギーが導入される 非平衡状態を考える。増幅と吸収は同じ確率で起こ るため、2つの準位だけのシステムでは反転分布を 作ることは出来ない。そこで、3または4準位のシ ステムを考える必要がある。

3準位系 3準位から成る図12のようなシステムを 考える。準位1と2の間に反転分布を形成するため に、もう一つ上の準位3が必要である。

全体の原子数をNとし、それぞれのエネルギー準 位にある原子数を N_1, N_2, N_3 とする。

$$N_1 + N_2 + N_3 = N \tag{141}$$

準位3は寿命が非常に短く、すぐに3 → 2 の遷移 が起こり、 $N_3 \sim 0$ となるとする。1 → 3 に相当す る励起エネルギー $P \epsilon$ 入力するときの吸収の係数を B_p とすると、 B_pN_1P の速度で1 → 3 の過程が起 こる。1 → 2 に相当するエネルギーの信号光の強度 を Iとすると、誘導放出の係数を Bとし、吸収によ る 1 → 2 過程は BN_1I 、誘導放出による 2 → 1 過程 は BN_2I の速度で起こる。また、自然放出の時定数 を τ とすると、入力光に無関係に、 N_2/τ の速度で 2 → 1 の過程が起こる。

これを微分方程式の形で表すと、

$$\frac{dN_2}{dt} = B_p N_1 P - \frac{N_2}{\tau} - N_2 BI + N_1 BI$$
(142)
$$\frac{dN_1}{dt} = -B_p N_1 P + \frac{N_2}{\tau} + N_2 BI - N_1 BI$$
(143)

となる。定常状態では、

$$\frac{dN_2}{dt} = \frac{dN_1}{dt} = 0 \tag{144}$$

となる。この条件で解いて、反転分布の大きさ $N_2 - N_1$ は、

$$N_2 - N_1 = \frac{N(P/P_0 - 1)}{1 + P/P_0 + 2I/I_s}$$
(145)

ここで、

$$B\tau = I_s, \quad \frac{1}{B_p \tau} = P_0 \tag{146}$$

とおいた。 $N_2 - N_1 > 0$ が反転分布という意味であ るから、反転分布の出来る条件は、 $P > P_0$ 、つまり ある閾値以上の励起エネルギーを投入することであ る。また、入力信号光を大きくしていって、 $I > I_s$ になると、反転分布が消費されてゲインが飽和し始 めることが分かる。

4 準位系 同様の計算を図 13 の 4 準位から成るシ ステムで行う。準位 3 は寿命が非常に短く、すぐに $3 \rightarrow 2$ の遷移がおきるとする。準位 1 は寿命が非常 に短く、すぐに $1 \rightarrow 0$ の遷移がおきるとする。その 結果、 $N_3 \sim 0, N_1 \sim 0$ になるとする。

全く同様の計算をして、反転分布の大きさは、

$$N_2 - N_1 = \frac{NP/P_0}{1 + P/P_0 + I/I_s}$$
(147)



図 12:3準位システム



図 13:4準位システム

となる。4準位のシステムでは、Pが小さくても反 転分布ができ、効率良く動作することが分かる。

2.4 光の伝搬

レーザー光が、狭線幅で回折限界の光であるため には、光の増幅と同時に帰還のメカニズムが重要な 役割を果たしている。共振器とよばれる空間に光を 閉じ込めることで、制限されたモードにエネルギー を集中する。共振器について議論するために、光の 伝搬則の理解が必要である。この伝搬則が、レーザー 光の横モードを決定する。

2.4.1 幾何光学

はじめに近軸光線の伝搬についてまとめておく。 任意の位置 *z* における光線を、軸からの距離 *r* と、 傾き dr/dz = r'で表すことにする (図 14)。



図 14: 光線



図 15: 光線の伝搬行列

$$\begin{pmatrix} r(z) \\ r'(z) \end{pmatrix} \tag{148}$$

地点1から地点2に向かって光線が伝搬するとき、2 点間の光線を2×2行列を使って、

$$\begin{pmatrix} r_2 \\ r'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r'_1 \end{pmatrix}$$
(149)

と書くことができる。間の光学要素がこの 2×2 行列 によって表される (図 15)。

たとえば、距離 d の自由空間は、

$$\begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{150}$$

焦点距離 f の薄レンズは、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0\\ -1/f & 1 \end{pmatrix} \tag{151}$$

である (図 16)。半径 ρ の凹面鏡は、焦点距離 $\rho/2$ の 凸レンズと同等である。ただし凹面鏡で入射が垂直 で無く、反射全角 α で用いる場合は、焦点距離に補



図 16: 自由空間と薄レンズ



図 17: 凹面鏡の反射

正因子が入る。紙面方向 (tangential) の焦点距離 f_t と、紙面に垂直 (sagittal) の焦点距離 f_s は一致せず、

$$f_t = \frac{\rho}{2}\cos(\alpha/2) \tag{152}$$

$$f_s = \frac{\rho}{2\cos(\alpha/2)} \tag{153}$$

となる (図 17)。

また、光学要素が連続する場合は、行列の積によっ て、全体を表現する行列を得る事ができる。

これらは、加速器の単粒子力学において、四極電 磁石などの収束要素を行列表現するのと全く同じで ある。

薄レンズをもう少し一般化し、収束作用がz方向 に連続的に分布する場合を考える(図18)。これは、 加速器の場合に厚みのある四極電磁石を扱う場合に 相当する。空間を無限に細かく分割して、自由空間 と薄レンズを交互に掛け合わせて表現すれば良く、



図 18: 連続分布する収束作用

分布した収束作用(距離 d)は、

$$\begin{pmatrix} \cos(\sqrt{k_2/k}d) & \sqrt{k/k_2}\sin(\sqrt{k_2/k}d) \\ -\sqrt{k_2/k}\sin(\sqrt{k_2/k}d) & \cos(\sqrt{k_2/k}d) \end{pmatrix}$$
(154)

と表されることが分かる。(横方向に屈折率が $n = n_0(1 - \frac{1}{2}\frac{k_2}{k})r^2$)と変わる媒質に相当する。)

2.4.2 ガウスビーム

電磁場の波動方程式

$$\nabla^2 A - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = 0 \tag{155}$$

を、単一周波数の場合について考える。 これを変数分離すると、

$$A = q(t)u(x, y, z) \tag{156}$$

と表され、空間部分については

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0 \tag{157}$$

 $(k = \omega/c)$ が得られる。これは、ヘルムホルツ方程 式と呼ばれる。

ここで、一様な自由空間の場合は*k*は定数である が、後の展開の伏線として、

$$k^2 = k^2 (1 - \frac{k_2}{k} r^2) \tag{158}$$

の形と仮定し、たまたま $k_2 = 0$ として考える。 ($r = \sqrt{x^2 + y^2}$ である。) 今、伝搬方向を z とし、

$$u(x, y, z) = \psi(x, y, z)e^{-ikz}$$
(159)

と書き、近軸近似

$$\left. \frac{\partial \psi}{dz} \right| \ll k |\psi|, \quad \left| \frac{\partial^2 \psi}{dz^2} \right| \ll \left| k \frac{\partial \psi}{dz} \right|$$
(160)

をすると、ヘルムホルツ方程式は、

$$i\frac{\partial}{\partial z}\psi = \frac{1}{2k}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi - \frac{k_2}{2}r^2\psi \qquad (161)$$

とかける。これは、調和振動子ポテンシャルの場合 のシュレーディンガー方程式と同じ形である。質量 に相当するものがkで、復元力のバネ定数に相当す るものが k_2 である。

ここで、 ψ は、zと r^2 の関数で書ける解を仮定する。そのような解を、

$$\psi = \exp\left(-i(P(z) + \frac{k}{2q(z)}r^2)\right)$$
(162)

と書く事にする。これを式161に代入すると、

$$\frac{r^2}{k^2} \left[\left(\frac{1}{q}\right)^2 + \left(\frac{1}{q}\right)' + \frac{k_2}{k} \right] + 2k \left[P' + \frac{i}{q} \right] = 0 \quad (163)$$

となり、これが全ての場所 (任意の r) で成立するためには、

$$(\frac{1}{q})^2 + (\frac{1}{q})' + \frac{k_2}{k} = 0$$
(164)

$$P' + \frac{i}{q} = 0 \tag{165}$$

となる。 ここで、

$$\frac{1}{q} = \frac{s'}{s} \tag{166}$$

を満たす関数 s(z) を導入し、式 164 を置き換えると、

$$s'' + s\frac{k_2}{k} = 0 \tag{167}$$

$$s(z) = a\sin(\sqrt{\frac{k_2}{k}}z) + b\cos(\sqrt{\frac{k_2}{k}}z) \qquad (168)$$

これをqの表式として書き直すと、

$$q(z) = \frac{\cos[\sqrt{k_2/k_z}]q_0 + \sqrt{k/k_2}\sin[\sqrt{k_2/k_z}]}{-\sqrt{k_2/k}\sin[\sqrt{k_2/k_z}]q_0 + \cos[\sqrt{k_2/k_z}]}$$
(169)

ここで、 $q_0 = q(z=0)$ である。

いったん戻って、 $k_2 = 0$ の場合を考える。この場合、式 164 は、

$$q' = 1 \tag{170}$$

になるので、

$$q(z) = z + q_0$$
 (171)

そして、

$$P(z) = -i\ln\left(1 + \frac{z}{q_0}\right) \tag{172}$$

 q_0 は、単に積分定数で、座標原点を決めるだけであるが、後の伏線として、

$$q_0 = i \frac{k w_0^2}{2} \tag{173}$$

と書く事にする。 $\ln(a + ib) = \ln \sqrt{a^2 + b^2} + i \tan^{-1}(b/a)$ などを使って整理すると、近軸ヘルムホルツ方程式の軸対称最低次の解は、以下の形に表される。

$$\psi(r,z) = \frac{Aw_0}{w(z)} \exp\left(-\frac{r^2}{w(z)}\right) \exp\left(-i\frac{kr^2}{2R(z)} + i\phi\right)$$
(174)

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{175}$$

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + (\frac{z}{z_0})^2}$$
 (176)

$$R = z \left(1 + (\frac{z_0}{z})^2 \right)$$
(177)

$$\phi = \tan^{-1}(\frac{1}{z_0})$$
(178)
$$z_0 = \frac{\pi w_0^2}{2}$$
(179)

 $z_0 = \frac{1}{\lambda}$

 $\lambda=2\pi/k\; {\rm \mathring{c}}\,{\rm \mathring{s}}\,{\rm \mathring{s}}_{\,\circ}$

これは、図 19 に示すように、z = 0の位置に収束 点を持ち、断面の電場強度がガウス型の分布のビー ムである (ガウスビームと呼ばれる)。収束点でのサ イズは w_0 で与えられる。これは、中心軸から w_0 だ け離れた位置で、電場強度が 1/e になるという意味 である。光子密度は電場の 2 乗であるから、光子密 度としては 2σ サイズに相当する。波長 λ が固定で あれば、(z 方向の平行移動を除いて) w_0 が唯一のパ ラメータである。任意の位置でのサイズは w(z) で 表され、収束点から離れるにつれて大きくなってい く。収束点から z_0 だけ離れると、サイズが $\sqrt{2}$ 倍に



図 19: ガウスビームの発散の様子



図 20: Gouy 位相の変化

なる。*z*₀ をレイリー長と呼び、絞ったサイズが維持 できる距離の指標である。*R* は波面の曲率半径を表 す。*φ* は Gouy 位相と呼ばれ、図 20 に示すように、 収束点を1回経由するとπだけ進む位相因子である。 これは、ガウスビームが一様な平面波ではなく、軸 上に局在化したビームであることから、導波管など と同じように位相速度が大きくなる現象に対応する。

レーザー光のような、単一周波数の回折限界光は、 ガウスビームとして空間を伝搬する。

2.4.3 転送行列

式 169 を、任意のzのときの解とz = 0のときの 解を関係づける式と見ると、たとえば、 q_1 から $q_2 \sim$ の関係は、

$$q_2 = \frac{A_1 q_1 + B_1}{C_1 q_1 + D_1} \tag{180}$$

q₂からq₃への関係は、

$$q_3 = \frac{A_2 q_2 + B_2}{C_2 q_2 + D_2} \tag{181}$$

これを合わせると、

$$q_3 = \frac{A_T q_1 + B_T}{C_T q_1 + D_T} \tag{182}$$

ここで、係数の A, B, C, D は、

$$\begin{pmatrix} A_T & B_T \\ C_T & D_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix}$$
(183)

と、行列の掛け算で表されることが確かめられる。 つまり、式169は行列で表すと、

$$\begin{pmatrix} \cos(\sqrt{k_2/kz}) & \sqrt{k/k_2}\sin(\sqrt{k_2/kz}) \\ -\sqrt{k_2/k}\sin(\sqrt{k_2/kz}) & \cos(\sqrt{k_2/kz}) \end{pmatrix}$$
(184)

ということで、幾何光学での光線の伝搬と全く同じ 表式になる。

 $k_2 \rightarrow 0$ で、自由空間を表すことになり、

$$\begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{185}$$

収束作用を一点のデルタ関数に集約すると、薄レン ズを表すことになる。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0\\ -1/f & 1 \end{pmatrix} \tag{186}$$

2.4.4 共振器

複数の鏡を使って閉じた空間を作ったものを共振 器という。図 21 は、2 枚の凹面鏡を使った最も単純 な構成である。凹面鏡はレンズと同等なので、この 共振器内を往復する光は、レンズと自由空間が繰り 返された光路を伝搬するものと考える事ができる。 この状況は、図 18 と似ていることから、ガウスビー ムの定常解が存在すると期待出来る。

1周期の伝搬行列を考えれば、共振器の特性を解 析することが出来る。例えばこの場合、鏡の間隔を *d*とし、凹面鏡の収束力を*f*とする。共振器の中央 を起点として1周期の伝搬行列は、

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{d}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{-1}{f} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{-1}{f} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{d}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
(187)

である。選んだ起点によって、行列の表式は変わる が、共振器の安定性などの結果は同じになる。



図 21: 共振器の例

共振器の定常解(固有モード)は、一周して元に戻 るという条件から、

$$q_s = \frac{Aq_s + B}{Cq_s + D} \tag{188}$$

を満たさなければならない。

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{R} - i\frac{\lambda}{\pi w^2} \tag{189}$$

の対応があることから、1/q_sの実部から波面の曲率 半径が分かり、虚部からビームサイズが分かること になる。具体的に解を書くと、

$$R = \frac{2B}{D-A} \tag{190}$$

$$w^{2} = \frac{\lambda}{\pi} \frac{|B|}{\sqrt{1 - (D+A)^{2}/4}}$$
(191)

である。

ここで得られた R と w は、起点での値である。任 意の点での値を知りたいときは、起点を変えてこの 計算を繰り返せば良い。w² < 0 になる場合は、安定 解が無く、共振器として成立しないことを意味する。

2.4.5 高次ガウスビーム

式 161 が調和振動子ポテンシャルのシュレーディ ンガー方程式と等価であることから、式 174 で得ら れた最低次の解の他に、高次の解がある。これは、 横モードとも呼ばれる。高次の解の表式は、最低次 の解に *a*[†]を掛けていく事で、次のものが得られる。

$$\psi(x, y, z) = \frac{Aw_0}{w(z)} H_m\left(\sqrt{2}\frac{x}{w(z)}\right) H_n\left(\sqrt{2}\frac{y}{w(z)}\right)$$
$$\times \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{w(z)^2}\right) \exp\left(i\frac{k(x^2 + y^2)}{2R(z)}\right)$$
$$\times \exp\left(i(m + n + 1)\phi\right)$$
(192)

 H_n の具体的な表式は、 a^{\dagger} を掛けていく操作から想像できるように、

$$H_n(x) = (-1)^n \exp(x^2) \frac{d^n}{dx^n} \exp(-x^2)$$
 (193)

例えば、

$$H_0(x) = 1$$
 (194)

$$H_1(x) = 2x \tag{195}$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2 (196)$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x (197)$$

である。図6で示したものと同じく、次数に応じて 断面方向の節が増える。これを、エルミートガウス ビームと呼び、HG_{mn}モードと書く。m,n はそれぞ れ x,y 方向の次数を表す。図 22 に、高次のモードの 断面プロファイルの例を示す。断面形状の他、Gouy 位相の進み方も次数に依存する。次数が高いほど、 位相の進みが速い。

2.5 縦モードとレーザー発振器

レーザー光の時間方向および波長方向の自由度は、 縦モードと呼ばれる。これは、共振器の周長から決 定される。

2.5.1 共振器の縦モード

共振器の進行方向の境界条件に注目する。簡単の 為、2枚の平面鏡が間隔 L で配置された1次元共振 器を考える。(平面鏡では収束効果が無いので安定で は無いが、今は無視して考える。また、Gouy 位相 や鏡の反射による位相シフトの効果もここでは考え 無い。)共振器内に存在できる電磁波は、

$$2L = m\lambda \quad (m = 1, 2, 3, \cdots)$$
 (198)

を満たすものに限られる。光周波数 ν としては、

$$\nu = \frac{mc}{2L} \tag{199}$$

で、これを共振器の縦モードと呼ぶ (図 23)。縦モードの間隔 $\Delta \nu = c/2L$ は、共振器の基本周波数 (光の速度で単位時間に共振器を何周回するか) に相当する。



図 22: 高次ガウスビームの断面形状



図 23: 共振器の縦モード

2.5.2 発振器

図 24 のように、共振器内部に光増幅器、つまり 反転分布した媒質、を置く。これがレーザー発振器 である。共振器内の光は離散的な縦モードおよび横 モードとしてしか存在しない。はじめ、自然放出に よって増幅器から、共振器とは無関係に光が放射さ れる。その一部で共振器のモードに合ったものは、 共振器に閉じ込められることになる。今度はそれが 光増幅器の入力光として働き、誘導増幅によって増 幅する。これが帰還的に起こり、共振器モードの光 が成長する。各モードについて、ゲインが損失を上 回っていればエネルギーが増大していく。レート方 程式で議論したように、入力光が大きくなると光増 幅器はあるところで飽和しゲインが低下する。最終 的には、共振器の損失とゲインが釣り合って、全体 のゲインが1となるところで定常状態が実現する。 つまり、共振器によって横にも縦にも特定のモード を選択し、光を増幅したものがレーザー発振器で、 いわゆるレーザー光として知られる、線幅が狭く指 向性の良い光ビームが実現する。

光増幅器は、原子準位によって動作帯域が決まっ ており、ゲインは周波数依存性を持っている。共振 器長が大きく、縦モード間隔が狭い場合は、増幅器 の動作帯域内に多数の縦モードが存在する。複数の 縦モードが同時に励起された状態を多縦モード発振 と呼ぶ。一方、共振器長が小さく、縦モード間隔が 十分広い場合は、1つの縦モードだけが成長する条 件になる場合があり、単一縦モード発振と呼ぶ。こ れは理想的な CW レーザーである。

共振器鏡の1つを、透過率のあるものとすると、 光を共振器の外に取り出す事ができる。

2.5.3 モードロック

多縦モード発振において、通常はそれぞれの縦モー ドは無関係に発振すると考えられるが、何らかの原 因で各縦モードの位相関係が固定されたとする。縦 モードが 2N + 1本あるとし、中心周波数を ω_0 、縦 モード間隔を $\Delta \omega$ とする。(ここでは角周波数で表す こととし、 $\omega = 2\pi\nu$ である。)簡単のため、全ての 縦モードの振幅は等しいとする。全ての縦モードを



図 24: レーザー発振器

足し合わせた電場は、以下のように計算される。

$$E(t) = \sum_{n=-N}^{N} E_0 \cos[(\omega_0 + n\Delta\omega)t] \qquad (200)$$

$$= E_0 Re \left[\sum_{n=-N}^{N} \exp[-i(\omega_0 + n\Delta\omega)t]\right]$$

$$= E_0 Re \left[e^{-i\omega_0 t} \sum_{n=-N}^{N} (e^{-i\Delta\omega t})^n\right]$$

$$= E_0 \frac{\sin[(N + \frac{1}{2})\Delta\omega t]}{\sin(\Delta\omega t/2)} \cos(\omega_0 t) \qquad (201)$$

つまり、 ω_0 で振動する電場が、振幅変調された形に なる。光強度はこれを2乗して、

$$I(t) = I_0 \frac{\sin^2[(N + \frac{1}{2})\Delta\omega t]}{\sin^2(\Delta\omega t/2)}$$
(202)

となる。これを図 25 に示す。 $1/\Delta \nu (= 2\pi/\Delta \omega)$ 、つまり共振器の基本繰り返しに相当するパルス列が得られることになる。また、縦モード数が大きい程、短いパルスになる。これが、モードロックパルスレーザーである。

どうやって多数の縦モードの位相を揃えるかが問 題である。色々な手法が確立しているが、基本的に は光の位相に直接働きかけるというよりは、強度の 時間変化に働きかけて、強いところをより強く、弱



図 25: 縦モードの加算によるパルス列

いところをより弱くするような仕組みを導入し、パ ルス構造を成長させるやり方をする。

代表的な例を2つ紹介する。図26は、可飽和吸収 体を使ったモードロック発振器の構成である。可飽 和吸収体とは、吸収体であって、その吸収の効果が 光強度によって飽和するものである。つまり、弱い光 に対しては光を損失するが、強い光に対しては損失 が小さい。このようなものを半導体で出来た鏡とし て作ったものが SESAM(SEmiconductor Saturable Absorber Mirror)である。これを共振器を構成する 鏡の一つとして用いる。図27で原理を説明する。通 常は、2準位系の下の準位にあって、光を吸収する (反射率が低い)が、高いピーク強度で光の吸収が進 み上の準位が埋まってくると、吸収率がさがる(反 射率が高い)。この作用によって、SESAMで反射さ れる度にピークが成長し、最終的にモードロック状 態になる。

図 28 は、ファイバ発振器で良く用いられる、非線 形偏波回転 (NLPR: Non-Linear Polarization Rotation) モードロックと呼ばれる方式である。シングル モード光ファイバ中では、断面が小さいため光強度 が強く、ファイバ (石英)の非線形効果の影響が見ら れる。強度に依存した屈折率の変化として現れ、偏 光方向を回転させる効果になる。偏光板と偏光スプ リッタ (PBS)の関係をうまく調整して、低強度では 損失が大きく、高強度では損失が小さい状態にする と、ピークが成長し、モードロック状態が実現する。



図 26: SESAM モードロック発振器



図 27: 可飽和吸収体によるパルスの生成



図 28: 非線形偏波回転によるファイバモードロック 発振器

2.6 レーザー増幅器

反転分布を作って、そこに種光を通せば、増幅される。増幅器は、結晶であったり、ファイバであったりする。励起方法も色々である。(省略。適当な参考書を参照)

2.7 波長変換

レーザーは、原子準位の遷移によって光増幅を行 うので、得られる波長は原子の種類で決まってしま う。必ずしも欲しい波長の光が直接に発振し、増幅 できるとは限らない。そこで、波長を変換する技術 が必要になる。特に、より短波長の光が欲しくなる のが常である。ここでは、波長変換の基本である2 倍波発生について説明する。通常、波長1µm 程度 の赤外で発振し、2倍波変換して可視域、さらに2 倍波変換して紫外域、と進んで行く。それ以上にな ると結晶では無理で、高次高調波という手法が用い られる。さらに短波長領域では、加速器を用いた自 由電子レーザーの出番になる。その次はコンプトン 散乱であろうか。

2.7.1 分極

ここでは、真空中ではなく、電流密度 *j* がある場合を扱う。

分極 Pを導入し、

$$j = \frac{dP}{dt} \tag{203}$$

$$\rho = -\nabla \cdot P \tag{204}$$

ここでは、Pは空間的に一様である場合に限って扱うので、式 103 より $\rho = 0$ である。

式 203 を式 104 に入れて、両辺に $\partial/\partial t$ して、*E* と ϕ の式に変換し、 $\rho = 0$ から *E* の式だけが残って、

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 P}{\partial t^2}$$
(205)

が得られる。

P は、

$$P = \epsilon_0(\chi^{(1)}E + \chi^{(2)}EE + \cdots)$$
 (206)

 $(\chi^{(n)}, EE$ とかはテンソル量)これを Eにたいする 線型部分 P_L と非線形部分 P_{NL} に分けて、

$$P_L = \epsilon_0 \chi^{(1)} E \tag{207}$$

$$P_{NL} = \epsilon_0(\chi^{(2)}EE + \chi^{(3)}EEE + \cdots)(208)$$

式 205 を、*E* の線型部分と非線形部分に分けて書 くと、

$$\nabla^2 E - \frac{1 + \chi^{(1)}}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 P_{NL}}{\partial t^2}$$
(209)

である。 $1 + \chi^{(1)} = n^2$ と書くと、 1 $a^2 E$ 1 $a^2 R$

$$\nabla^2 E - \frac{1}{(c/n)^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 P_{NL}}{\partial t^2}$$
(210)

となる事から分かるように、これは、屈折率nの空間に P_{NL} を起源とする放射源があると理解できる。 (真空中と比べて伝搬速度がc/nになった。)

ここでは非線形分極は2次までを考えることにする。(2倍波発生は、2次の非線形現象である。)

$$P_{NL} = \epsilon_0 \chi^{(2)} E E \tag{211}$$

反転対称性がある系の場合、*P*と*E*を同時に符号反転しても変化しないはずである。

$$-P_{NL} = \epsilon_0 \chi^{(2)}(-E)(-E)$$
 (212)

式 211,212 を見比べると、 $\chi^{(2)} = 0$ でなければ辻褄 が合わない。反転対称性がある系では 2 倍波発生は 出来ないことが分かる。つまり、2 倍波発生のため には、反転対称性を持たない非線形結晶が必要とい うことである。

2.7.2 位相整合

入力する基本波が、発生する高次波に比べて十分 大きい場合を考える。

分極の伝搬が、

$$P_{NL} = \overline{P_{NL}} \exp(i(\omega_{NL}t - k_{NL}z))$$
(213)

で表される波として伝わるとする。 $(\overline{P_{NL}} \text{ th } z \text{ cc} \text{ ck}$ らない)

高次波の伝搬を、

$$E = E(z) \exp(i(\omega_{NL}t - k(\omega_{NL})z))$$
(214)

と書く。屈折率 n は周波数成分の関数であるとし、

$$k(\omega_{NL}) = (\omega_{NL}/c)^2 n_{\omega_{NL}} \tag{215}$$

の関係がある。

式 210 に代入して整理すると、

$$\frac{\partial^2 E(z)}{\partial z^2} - 2ik(\omega_{NL})\frac{\partial E(z)}{\partial z} = \frac{\omega_{NL}^2}{c^2\epsilon_0}\overline{P_{NL}}\exp(i(k(\omega_{NL}) - k_{NL})z)$$
(216)

E(z)はzにたいしてゆっくり変化するとすると、

$$\frac{\partial E(z)}{\partial z} = \frac{\omega_{NL}^2}{2i\epsilon_0 c^2 k(\omega_{NL})} \overline{P_{NL}} \exp(-i\Delta kz) \quad (217)$$

ここで、
$$\Delta k = k(\omega_{NL}) - k_{NL}$$
である。
これを距離 L だけ積分すると、

$$E(L) \propto \exp(i\frac{\Delta kL}{2})\overline{P_{NL}}L\frac{\sin(\Delta kL/2)}{\Delta kL/2}$$
 (218)

強度 I は |E|² なので、

$$I(L) \propto L^2 \frac{\sin^2(\Delta k L/2)}{(\Delta k L/2)^2}$$
(219)

である。

 $\Delta k = 0$ なら、Lが大きいほど強くなるが、 $\Delta k \neq 0$ の場合、 $L = \pi/(2\Delta k)$ で減少に転じ、 $L = \pi/\Delta k$ ゼロになってしまう。

2 倍波変換の場合は、 $\Delta k = 0$ の条件は、 $k_{2\omega} = 2k_{\omega}$ ということで、つまり、屈折率が、 $n_{2\omega} = n_{\omega}$ ということである。

2.7.3 複屈折結晶

通常の透明媒質の場合、周波数が高くなるほど、屈 折率が大きくなる。つまり、 $n(2\omega) > n(\omega)$ である。

複屈折を持つ結晶(ここでは1軸性を仮定で、図 29のように入射するとする)の場合、偏光成分と進 行方向に依存して屈折率が変わる。

$$n_o(\theta) = n_o \tag{220}$$

$$\frac{1}{n_e(\theta)^2} = \frac{\cos^2\theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2\theta}{n_e^2}$$
(221)

 n_o は結晶軸と垂直方向の電場の偏光にたいする屈折 率、 n_e は結晶軸と平行方向の電場の偏光にたいする 屈折率である。 $n_e < n_o$ の場合を、負の一軸性結晶 と呼ぶ。

式 221 より、 $n_e(\theta)$ は、長軸半径が n_o で短軸半径 が n_e の楕円の原点から θ 方向の距離と考える事が出 来、図 30 のように示す事が出来る。 $n_o(2\omega) > n_o(\omega)$, $n_e(2\omega) > n_e(\omega)$ だが、 $n_e(2\omega) < n_o(\omega)$ となり得る 場合がある。つまり、 $n_e(2\omega)$ を示す楕円と、 $n_o(\omega)$ を 示す円が交わる条件の入射角 θ において、 $n_e(2\omega) = n_o(\omega)$ が成立する。

2.7.4 高次高調波

より短波長のレーザー光が欲しいが、紫外域になっ てくると、そもそも透明な結晶が無い。そこで、結 晶ではなく、ガスを利用することが考えられる。通 常、キセノンなどのガスジェットにレーザー光を入 射する。当然、ガスは反転対称性があるため、偶数 次の高調波は発生しないが、奇数次は発生し得る。



図 29: 一軸性複屈折結晶の結晶軸と入射光の関係



図 30: 位相整合



図 31: 高次高調波発生の3ステップモデル

この過程による高次高調波の発生は、図 31 のよ うなモデルで説明される。レーザーの光電場によっ て、ガス原子のポテンシャルが傾き、原子に束縛さ れていた電子が、トンネル効果で真空中に放出され る。光電場は周期的に変動するため、放出した電子 を加速して引き戻す。電子が再び原子に再結合する 際に、運動エネルギーとイオン化エネルギーに相当 するエネルギーを光として放出する。この過程が光 電場の半周期毎に位相を反転しておこる。図 32 に示 すような電場波形が生成され、これを周波数領域で みると、基本光の奇数次の高調波が生成されること になる。

自由電子が、振動電場中に置かれた場合、電場に よって振動運動をする。このとき、電子が持つ平均 の運動エネルギーはポンデロモーティブエネルギー U_pと呼ばれ、

$$U_p = \frac{eE_0^2}{4m_0\omega^2}$$
(222)

である。(電場の振幅を E_0 、角周波数を ω 、電子の 質量を m_0 、電荷をeとした。)

放出された電子が戻って来たときに得る運動エネ ルギーは、一声、これの3倍程度と考えられるので、 光子として放出され得るエネルギーは、 $I_p + 3U_p$ が 最大である。



図 32: 高次高調波発生の3ステップモデル

3 光源加速器における応用

3.1 フォトカソードの励起

線型加速器による光源加速器では、ビームの性能 は電子源できまる。このため、低エミッタンスの電 子源が重要で、フォトカソード電子銃が用いられる。 これは、電子銃の高電圧陰極部に備えられたフォト カソードをパルスレーザー光で照射して励起し、電 子ビームを生成するものである (図 33)。

熱電子銃と比較して、フォトカソード電子銃は、電 子の生成を時間的にも空間的にもレーザーによって 制御することができる。特に、後段の RF 加速空洞 での加速位相に合わせて電子バンチを生成する事が 出来るため、短バンチで、エミッタンスの良いビー ムが得られる。

ここでは、極低エミッタンスが実現できることで 知られる半導体フォトカソードを仮定して議論する。 電子が真空中に取り出されて以降の事は他で説明が あるはずなので、ここではレーザー光で半導体フォ トカソードを励起し、電子が取り出されるまでの過 程について説明する。

3.1.1 半導体のエネルギー準位

結晶は、内部の電子にとっては原子の並びによっ て設定された周期的なポテンシャルの空間である。 これを、図 34 のように簡単なモデル化をして考え る事ができる。周期が a の矩形ポテンシャルとして 導入するが、障壁を、面積を一定にして幅をゼロに



図 33: フォトカソード



図 34: 周期ポテンシャル



図 35: 周期ポテンシャルの分散関係

する極限をとり、デルタ関数として扱って、ポテン シャルの具体的な形状に依存しない議論になる (ク ローニッヒ-ペニーモデル)。シュレーディンガー方程 式から固有エネルギーを求め、図 35 に示すような、 エネルギーと波数の関係 (分散関係) が得られる。自 由空間の場合は、連続な 2 次関数の分散関係が得ら れる (この 2 次の係数が有効質量を意味する) のにた いして、周期ポテンシャルの場合は、不連続点が出 来、とり得ないエネルギー (バンドギャップ) がある ことが分かる。

ak について 2π の整数倍は高次のモードとして 0 < ak < π の範囲にまとめて表示 (還元ゾーン表記) すると、波数ゼロの付近で、バンドギャップの下側 は上に凸、上側は下に凸の構造ができることが分か る。これを図 36 に示す。半導体結晶は、バンドギャッ プの下側の上端までが電子で埋まっている (価電子 帯)。バンドギャップの上側の領域は伝導帯と呼ばれ る。下に凸になっていることから分かるように、電 子が運動エネルギーを持って自由に動き回ることが



図 36: 周期ポテンシャルの分散関係

出来る状態である。

2準位系と放射の相互作用で議論したように、準 位間のエネルギー差に相当する光が入力されると、 吸収および誘導放出が起こる。半導体では、下の準 位である価電子帯が埋まっているので、光は吸収さ れ、電子の状態は上の準位に遷移する、つまり伝導 電子が生成することになる。

3.1.2 状態密度

半導体中の伝導電子は、質量 m が有効質量 m* に 置き換わっただけで、あたかも自由空間にあるよう に動く。つまり、エネルギー固有状態は、自由空間 のシュレーディンガー方程式に従う波動として扱う ことが出来る。

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\nabla^2\psi = E\psi \tag{223}$$

これは、式113と同じなので、電磁波モードと同じ 手順で状態の数を計算することが出来る。

エネルギーと波数 kの関係が、

$$E = \frac{\hbar^2}{2m^*}k^2 \tag{224}$$

である点が、光と電子の違いであることに注意し、3 次元の半導体の場合について状態密度を計算する。 式 133 と同様に、3次元波数空間で格子点の数を数 える計算を行い、状態密度関数 *S*(*E*) は、

$$S(E) \propto 4\pi k^2 \frac{dk}{dE}$$
 (225)

$$\propto \sqrt{E}$$
 (226)



図 37: エネルギーと状態密度

となる。ついでに、2次元の場合は、

$$S(E) \propto 2\pi k \frac{dk}{dE}$$
 (227)

$$\propto const.$$
 (228)

1 次元の場合は、

$$S(E) \propto \frac{dk}{dE}$$
 (229)

$$\propto \frac{1}{\sqrt{E}}$$
 (230)

である。

3次元の自由度を持つ系の場合は、運動エネルギー が高くなる程、とり得る状態が増える (図 37) こと が分かる。

光のエネルギーと励起効率について考える。エネ ルギーがバンドギャップ以下の場合は、エネルギー保 存が成り立たないので励起できず、光は吸収されな い(透明)。バンドギャップより少し高いエネルギー の光を入力する場合は、生成される伝導電子の運動 エネルギーは小さい。図37より、Eが小さい領域の 状態密度は小さい。遷移確率は状態数に比例するの で、励起効率は低く、光の吸収は小さい(吸収長が 長い)。光のエネルギーが高くなるに従って状態数が 大きくなるので、励起効率が高くなり、吸収長が短 くなる。つまり、波長の短いレーザー光を使うほう が、量子効率が高く、時間応答が短くなる。

図 37 を見ると、2 次元の系の場合は状態数が運動 エネルギーに依らないので、運動エネルギーが小さ い領域でも状態数が大きく、励起効率が高くなる可 能性がある。ただ、2 次元ゆえに体積が稼げず、や はり励起効率で不利である。

3.1.3 伝導電子の輸送

図 36 に示すように、伝導電子は、ある運動エネル ギーを持って生成する。光のエネルギーが大きい(波 長が短い)ほど、初期運動エネルギーは大きい。理 想的な周期ポテンシャルの空間であれば、あたかも 自由空間のように伝導電子は抵抗無く移動するはず であるが、実際は不純物や格子振動によって周期性 が崩れている。そのため、伝導電子は格子と散乱を 繰り返し、初期運動エネルギーを失い、伝導体の底 のエネルギーに落ち込み、最終的には室温の熱振動 と平衡状態になる(緩和)。緩和した後は、結晶内を 熱運動でランダムウォークして拡散する。

個々の伝導電子の動きを追いかけて考える事もで きるが、ここでは、多数の伝導電子があるとして、 伝導電子密度を c(x,t) で表し、その時間発展で伝導 電子の移動を議論することにする。拡散では、密度 の勾配に比例して移動が起こり、それが電流密度 J_c であるから、

$$J_c(x,t) = eD\frac{\partial c(x,t)}{\partial x}$$
(231)

また、ある地点において流れ込む電流と流れ出す電 流の差は、電荷の変化を意味するから、

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial J_c(x,t)}{\partial x}$$
(232)

これらをまとめて、

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c(x,t)}{\partial x^2}$$
(233)

これは、拡散方程式と呼ばれる。Dは拡散の速度を 表す拡散係数で、結晶の物性で決まる。式 233 の意 味する所を図 38 に示す。つまり、密度の高いところ (上に凸)は減少しようとし、密度の低い所(下に凸) は増加しようとする。

微分方程式を解く際には、境界条件が必要である。 例えば、カソード表面 (x = 0) では、伝導電子が消 減する (外に取り出されるか、表面で再結合する) わ けであるから、

$$c(x = 0, t) = 0 \tag{234}$$

の境界条件を設定する。真空に放出されるビーム電流 *I*は、表面での電流に比例すると考えられるので、



図 38: 拡散による時間発展



図 39: 境界条件の設定

式 231 を参考に、

$$I \propto \frac{\partial c(x=0)}{\partial x} \tag{235}$$

で得られる。

もし、図 39 の x = h の地点のようにポテンシャ ル障壁の境界条件を仮定するなら、そこでの電流密 度がゼロという条件より、

$$\frac{\partial c(x=h)}{\partial x} = 0 \tag{236}$$

を設定すれば良いことになる。

3.1.4 時間応答

取り出される電子ビームの時間構造は、伝導電子 密度の時間発展を追いかければ計算できる。まず、 カソードは十分厚い半導体結晶 (バルク)の場合を考 えてみる。図 40 で説明する。カソードの表面から レーザーを照射すると、カソード深部に行くに従っ て、波長に応じた吸収長で指数関数的に光が減衰し ていく。光強度に比例して伝導電子の初期分布が生



図 40: カソードの時間応答

成する。この分布から始まり、拡散方程式と表面の 境界条件に従って、分布が時間発展していく(上図)。 表面から電子が放出されると同時に、分布は深部に まで拡散していく。ビームとして取り出される電流 は、下図のような時間応答をすることになる。初期 分布からすぐに取り出された速い成分と、一旦深部 まで拡散してから出てくる遅いテイル成分ができる。

テイル成分の無い速い時間応答を望むなら、吸収 長の小さい、短波長光で励起するのが良い。初期分 布が表面近傍に局在するので、相対的に速い成分が 大きくなる。あるいは、厚みの薄い結晶を使い、深 部に拡散しないようにすることで時間応用を良くす ることも出来る。

3.1.5 初期エミッタンス

規格化 RMS エミッタンスは、

$$\varepsilon_n = \frac{1}{mc} \sqrt{\langle x^2 \rangle \cdot \langle p_x^2 \rangle - \langle x \cdot p_x \rangle^2} \tag{237}$$

で定義される。m は真空中の電子の質量、x は横方 向の位置、 p_x は運動量である。カソード上では位置 と角度には相関が無い ($\langle x \cdot p_x \rangle = 0$) と考えられる ので、

$$\varepsilon_n = \frac{1}{mc} x_{rms} \cdot p_{x_{rms}} \tag{238}$$

である。また、横方向1自由度辺りの運動エネルギー *E_T*

$$E_T = \frac{p_x^2}{2m} \tag{239}$$

を使い、カソード上でのビーム形状を半径 Rの一様 分布として、 $x_{rms} = R/2$ を使うと、

$$\varepsilon_n = \frac{R}{2} \cdot \sqrt{\frac{2\langle E_T \rangle}{mc^2}} \tag{240}$$

となる。つまり、初期エミッタンスは、ビームサイズ と、放出される電子の持つ横方向の運動エネルギー で決まる。

ビームサイズは、励起するレーザーのスポットサ イズで決められ、小さい程、低エミッタンスになる。 伝導電子が結晶中で室温 (k_BT)まで緩和している とすると、結晶中での横方向1自由度あたりの運動 エネルギー $\langle E_T^* \rangle$ は

$$\langle E_T^* \rangle = \frac{1}{2} k_B T \tag{241}$$

と考えられる。

これが、真空中に放出される際、有効質量 m* が 真空中の質量 m に変化する。このときの横方向の運 動量の保存を考えると、

$$m^* E_T^* = m E_T \tag{242}$$

が成り立たなければならない (質量効果、図 41)。こ れを踏まえると、

$$2\langle E_T \rangle = \frac{m^*}{m} k_B T \tag{243}$$

となる。例えば GaAs の場合、 $m^* = 0.067m$ である から、理想的な場合は室温の 1/15 に相当する極低 エミッタンスが実現する可能性がある。

実際には、表面の状態によって、散乱や表面粗さの影響で、縦方向の運動エネルギーが横方向に回り込んでしまう。これが 〈*E_T*〉を決めている。

短波長の光で励起すると、時間応答は良くなる一 方で、完全に緩和する前に取り出される割合が増え、 エミッタンスは増える傾向になる。

3.2 高次横モードレーザー加速

レーザーを使って荷電粒子を加速しようというア イデアは、古くからある。現在、レーザーで駆動し たプラズマによる加速の研究は、国内外で多く行わ れているが、ここでのテーマである ERL による光



図 41: 表面での質量効果

源加速器と絡めた議論はあまりなされていない。ガ スジェットを使うという特殊な状況が、既存の加速 器とうまく組み合わせるのが難しくしているし、そ もそも低繰り返しの超高強度レーザーを使う為、高 繰り返しが利点の ERL とは整合しない。

ここでは、それらとは異なり、レーザーの光電場 による真空中の直接加速の方式について紹介する。 ERL 光源加速器においては、ビームの平均エネル ギーを上げる (いわゆるビームの加速) というより は、バンチ内粒子にエネルギー変調を与えるような 応用が、まず考えられる。

3.2.1 進行方向電場

通常、光は横波で進行方向の電場を持たないの で、荷電粒子の加速には使用できない (Lawson-Woodward の定理)。しかし、これは光が一様な平 面波の場合の話で、特殊な場合については実際に荷 電粒子を加速することが可能である。ここでは、空 間的に一様でないレーザー光の場合には進行方向電 場が存在し、電子ビームにレーザー光を重ねて伝搬 させることで電子ビームにエネルギーを与えること が出来ることを説明する。

z 方向に伝搬するレーザー光を考える。電場は x 方向に直線偏光とし、磁場は z 方向成分を持たない、 TM 波を考える。つまり、以下の条件である。(磁場と



図 42: TM10 モードの横電場のプロファイル

電場は独立では無いので、 $B_u \ge E_x$ は関係をもつ。)

$$E_y = 0 \tag{244}$$

$$B_x = 0 \tag{245}$$

$$B_y = \frac{1}{c} E_x \tag{246}$$

$$B_z = 0 \tag{247}$$

 E_z は z 方向の進行波の形、 $|E_z| \exp(i(\omega t - kz))$ と する。 $\omega = kc$ である。マクスウェル方程式、

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial t} = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y}$$
(248)

に代入して整理すると、

$$ikE_z = \frac{\partial E_x}{\partial x} \tag{249}$$

つまり、横方向の電場の空間変化があると、そこに は進行方向の電場が存在することが分かる。

例えば、式 192 の高次ガウシアンモードで *n* = 1,*m* = 0 のもの、TEM₁₀ モードは、簡単に書くと、

$$E_x \propto x e^{-x^2} \tag{250}$$

である (図 42)。この場合、進行方向電場は、

$$kE_z = (1 - 2x^2)e^{-x^2} \tag{251}$$

で与えられる。中央付近 (*x* = 0) に、1/*k* 相当の進 行方向電場があることが分かる (図 43)。



図 43: TM10 モードの横電場と縦電場



3.2.2 エネルギーゲイン

図44のように、電子ビームと同じ方向に進行方向 電場を持つレーザー光を伝搬させる。電子ビームも レーザー光の位相速度も光速とすると、バンチ内の 個々の粒子にたいする光電場の位相関係は固定され るので、進行方向電場が加速位相にある電子は常に 加速され、減速位相にある電子は常に減速される状 況になる。

横電場のピーク値を E_0 として、ウェストサイズ w_0 の場合、おおざっぱに、 $\frac{\partial E_x}{\partial x} \sim \frac{E_0}{w_0}$ であるから、

$$|E_z| = \frac{E_0}{kw_0} \tag{252}$$

である。

レーザーのピークパワーがPの場合、パワー密度Sは、ひとこえ、

$$S = \frac{P}{w_0^2} = c\epsilon_0 E_0^2$$
 (253)

である。進行方向電場は、

$$E_z = \frac{1}{kw_0^2}\sqrt{\frac{P}{c\epsilon_0}} = \frac{1}{2z_0}\sqrt{\frac{P}{c\epsilon_0}} \qquad (254)$$

 z_0 はレイリー長で、収束されたレーザー光が維持で きる距離に相当する。収束点から z_0 以上離れると、 径が拡がってしまうことと、Gouy 位相の効果で位 相が進んでしまうため、加速出来なくなってしまう。 実効的に加速に効く距離は $2z_0$ 程度と考えられるの で、エネルギーゲイン*G* は、

$$G = E_z \times 2z_0 = e\sqrt{\frac{P}{c\epsilon_0}} \tag{255}$$

となる。 z_0 あるいは w_0 に依らず、レーザーのピー クパワーのみで決まる。P = 100 MW で、G = 200keV のエネルギー変調を与えることが出来る計算で ある。これは、100 MeV 程度のビームにたいして ~ 10^{-3} のエネルギー変調を与えることに対応する。 ビームのもともとのエネルギー広がりと同等以上の 変調で、後述する位相空間の制御に応用するのに適 している。ピークパワー 100 MW 程度のレーザー光 は、例えば共振器蓄積の手法によって実現可能であ ると考えられる。

3.3 アンジュレータにおけるビームとレー ザーの相互作用

前節では、レーザー光の進行方向電場を使ってビー ムと相互作用する方法を説明したが、アンジュレー タと呼ばれる装置を使ってビームに軌道を横に振る と、レーザー光の横電場で相互作用させることがで きる。

これによって、ビームにエネルギー変調を与えた り、ビームからエネルギーを取り出したり、逆にビー ムにエネルギーを与えたりできる。

3.3.1 アンジュレータでのビーム軌道

アンジュレータは、周期的な磁場によって、ビー ム軌道を蛇行させる装置 (図 45) である。アンジュ レータの磁場を垂直方向とし、

$$B_y = B_0 \cos(k_u z) \tag{256}$$



図 45: アンジュレータ

とする。アンジュレータの周期を λ_u とし、 $k_u = 2\pi/\lambda_u$ とおいた。zは (蛇行運動を無視した) ビーム進行方向である。

この磁場中での電荷 *e* で質量 *m*₀ の電子の運動方 程式は、

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\frac{eB_0}{m_0\gamma}\frac{dz(t)}{dt}\cos(k_u z) \quad (257)$$

$$\frac{d^2 z(t)}{dt^2} = \frac{eB_0}{m_0 \gamma} \frac{dx(t)}{dt} \cos(k_u z) \qquad (258)$$

と表す事が出来る。

式 257 を積分して、

$$\frac{dx(t)}{dt} = -\frac{cK}{\gamma}\sin(k_u z) \tag{259}$$

さらに積分して、軌道は

$$x(t) = \frac{K}{k_u \gamma} \cos(k_u z) \tag{260}$$

となる。ここで、

$$K = \frac{eB_0}{k_u m_0 c} \tag{261}$$

とおいた。

式 258 に代入すると、

$$\frac{d^2 z(t)}{dt^2} = -\frac{eB_0 cK}{m_0 \gamma^2} \sin(k_u z) \cos(k_u z)$$
(262)

両辺を積分して、

$$\left[\frac{dz}{dt}\right]_0^z = \frac{eB_0cK}{2m_0\gamma^2} \int_0^z \sin(2k_u z) \frac{dt}{dz} dz \qquad (263)$$

 $dz/dt \sim \beta c$ と近似して、両辺それぞれ計算すると、

$$\frac{dz}{dt} - \beta c = \frac{K^2 \beta c}{4\beta^2 \gamma^2} (\cos(2k_u z) - 1)$$
(264)

$$\beta = 1 - \frac{1}{2\gamma^2} \tag{265}$$

の関係を代入して整理すると、

$$\frac{dz}{dt} = c \left(1 - \frac{1 + K^2/2}{2\gamma^2} \right) + \frac{K^2 \beta c}{4\beta^2 \gamma^2} \cos(2k_u z) \sim c \left(1 - \frac{1 + K^2/2}{2\gamma^2} \right) = \beta^* c$$
(266)

振動する項は平均するとゼロなので無視した。

$$\beta^* = 1 - \frac{1 + K^2/2}{2\gamma^2} \tag{267}$$

は、進行方向の平均的な速度を意味する。蛇行運動 するために、βより少し小さい。

3.3.2 共鳴

アンジュレータにおいて、電子は β^*c の速度でz方向に進むことが分かった。一方、電子に沿わせるようにz方向にレーザー光を入れると、当然ながら光はcの速度で進行する。

アンジュレータの1周期 λ_u だけ進んだとき、電子と光で到達時間にずれが生じるが、その差をレー ザー光の波長 λ を単位として $n\lambda$ と表すことにする。

$$\left[\frac{\lambda_u}{\beta^* c} - \frac{\lambda_u}{c}\right] = \frac{n\lambda}{c} \tag{268}$$

これを整理すると、

$$n\lambda = \frac{\lambda_u}{2\gamma^2} \left(1 + \frac{K^2}{2} \right) \tag{269}$$

n が整数の場合、1 周期毎にずれるが、丁度波長の 整数倍ずれたので同じ位相にある、という条件が成 立する。これを共鳴と呼ぶ。

3.3.3 ビームとの相互作用

アンジュレータに導入するレーザー光をx 偏光とし、電場 E_x を次のように表す。

$$E_x = E_0 \cos(kz - \omega t + \phi_0) \tag{270}$$

式 260 の電子の横方向運動を合わせて考える。電場 方向に電子が運動すると、電場が電子ビームに仕事

をすることになる。つまり、加速または減速の作用 が起こる。電子が得るエネルギーは、

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{2}{m_0} \frac{dx(t)}{dt} E_x$$

$$= -\frac{eKE_0}{m_0 c\gamma} \sin(k_u z) \cos(kz - \omega t + \phi_0)$$

$$= -\frac{eKE_0}{2m_0 c\gamma} [\sin((k_u + k)z - \omega t + \phi_0) + \sin((k_u - k)z + \omega t - \phi_0)]$$

$$= -\frac{eKE_0}{2\pi m_0 c\gamma} \sin \phi$$
(272)

となる。ここで、

$$\phi = (k_u + k)z - \omega t + \phi_0 \tag{273}$$

とおき、速く振動する項はゼロとした。φは電子と レーザーとの相対的な位相を表す。つまり、位相関 係によって、加速だったり減速だったりする。

 ϕ の変化を表す方程式は、

$$\frac{d\phi}{dz} = \frac{d\phi}{dt}\frac{dt}{dz} = k_u + k - \frac{\omega}{dz/dt} \quad (274)$$
$$= k_u + k(1 - \frac{1}{\beta^*}) \quad (275)$$

となる。

エネルギーを共鳴条件を満たすエネルギー γ_r からの差分で

$$\gamma = \gamma_r + \Delta \gamma \tag{276}$$

と表現すると、最終的に一組の微分方程式が得られ る。

$$\frac{d\phi}{dz} = 2k_u \frac{\Delta\gamma}{\gamma_r} \tag{277}$$

$$\frac{d(\Delta\gamma)}{dz} = -\frac{eKE_0}{2m_0c^2\gamma_r}\sin\phi \qquad (278)$$

つまり、エネルギーと位相で表現した位相空間を回 転する運動をすることが分かる。

この様子を図 46 に示す。Δγ = 0 の直線上の分布 を初期状態とする。つまり、共鳴エネルギーに一致し たビームを入力する場合である。まず、式 278 に従っ て、サイン関数状にエネルギーが変調される。エネ ルギー変調が大きくなるにつれて、式 277 に従って、 位相がシフトしていく。これを続けて行って、レー ザー光の波長の周期構造で位相空間で回転すること



図 46: 位相空間上の運動 (共鳴エネルギー)



図 47: 位相空間上の運動 (共鳴エネルギーより少し 高い場合)

になる。加速と減速が同時に起こるので、平均のエ ネルギーのやりとりは無い。

ビームエネルギーが、アンジュレータの共鳴エネ ルギーより少し高い場合について、同様に計算した 結果が図 47 である。この場合、まずサイン関数状に エネルギーが変調されるのは同じであるが、位相空 間では共鳴エネルギーを中心に回転するので、回転 が進むと平均してエネルギーが下がってくる。ビー ムがエネルギーを失うわけであるから、このとき光 のエネルギーが増大する。

3.3.4 長手方向分散

加速器のある領域をビームが通過する際、エネル ギーの違いによって到達時間 (あるいは軌道長) が異 なる場合がある。 z_1, z_2 をそれぞれ、領域の入口と出 口における、バンチの中心を原点とした前後方向の位 置、 δ をビームのエネルギーからのずれ ($\delta = \Delta \gamma / \gamma$) とし、

$$z_2 = z_1 + R_{56}\delta + T_{566}\delta^2 + \cdots$$
 (279)

と表す。 R_{56} は線型項、 T_{566} は2次の項である。こ こでは線型項だけ扱うことにする。ひとまず、ビー ムエネルギーが十分高く、エネルギーが変わっても 速度変化しないと仮定すると、エネルギー差が軌道 に影響するのは、分散があり、かつ、軌道が曲率を もつ領域、つまり偏向電磁石の部分だけである。こ の関係は、図 48 に説明される。曲率半径 ρ をもつ軌 道の角度 $\delta\theta$ に対応するある微小区間を考える。この 区間における分散を η 、分散の変化率を η' とする。 基準軌道の距離を δs とすると、

$$\delta s = \rho \delta \theta \tag{280}$$

エネルギーが $\Delta\gamma$ だけことなる場合の軌道長 $\delta s'$ は、

$$\delta s' = \sqrt{((\rho + x)\delta\theta)^2 + (x'(\rho + x)\delta\theta)^2}$$

$$\sim (\rho + x)\delta\theta \qquad (281)$$

単位長さあたりの軌道長の差 $(\delta s' - \delta s)/\delta s$ は、

$$\frac{\delta s' - \delta s}{\delta s} = \frac{x}{\rho} = \frac{\eta}{\rho} (\Delta \gamma / \gamma)$$
(282)

これより、R₅₆は、次式で計算できる。

$$R_{56} = \int \frac{\eta_x(s)}{\rho(s)} ds \tag{283}$$

図 49 に示すような単純なシケイン部の場合、エネ ルギーが高いほど軌道長が短くなるので、 $R_{56} < 0$ である。

エネルギー変化による速度の違いが気になる場合 は、それを含めて R₅₆ と考えても良い。その場合は、 曲率と分散の無い領域でも R₅₆ は有限の値をもつ。

 $z \& \delta$ による長手方向の位相空間における、有限 な R_{56} の要素の作用を図 50 に示す。 $R_{56} > 0$ の場 合、上半平面は右にシフトし、下半平面は左にシフ



図 48: エネルギーによる軌道長の違い



図 49: シケインの例



図 50: 長手方向位相空間での作用



図 51: サイン型エネルギー変調構造の変化

トするような作用である。前節の式 277 は、アンジュ レータ自体の分散関係である。

例えば、ビーム進行方向にサイン関数状にエネル ギー変調の構造があるとし、これが有限な R₅₆の分 散領域を通過した後でどう変化するかを考えてみる。 図 51 に示すように、はじめサイン関数型だったもの が横方向に引き延ばされる効果になる。

特に、

$$R_{56}\frac{\Delta\gamma}{\gamma} = \lambda/4 \tag{284}$$

の場合に、エネルギー変調がのこぎり状に立った状 態になり、大きな密度変調が出来る。

3.4 レーザーによる位相空間の制御

前節の議論で、共鳴条件を満足する関係でアンジュ レータを通過するビームにレーザー光を重ねて伝搬 させると、レーザーの波長の周期でエネルギー変調 を与えることが出来ることが分かった。さらに、エ ネルギー変調がついたビームをシケインなどの R₅₆ を制御する区間に通過させることで、位相空間上で 動かすことが出来ることも分かった。この手法には 多彩な応用が考えられる。

3.4.1 レーザースライス

電子ビームのバンチ長が比較的大きい、蓄積リン グなどにおいて、実効的に短いバンチを模擬するも のとして、レーザーバンチスライシングという手法 が知られている。これは、電子バンチより短いパル



図 52: レーザースライシングによる短パルス X 線の 発生

スレーザーを使って、バンチ内に時間方向に短い構 造を作るものである。図 52 のように、アンジュレー タ内で電子の一部に重なるようにレーザーを相互作 用させ、エネルギー変調を生成する。下流の偏向電 磁石等におけるシンクロトロン放射光を利用する際 に、エネルギーの違いによる軌道と放射方向の違い で分離することで、短パルスの放射光を得ることが 出来る。

このエネルギー変調が、下流の分散部を通過する 際に、図 53 に示すように密度変調に変換される。結 果的にレーザーと重なっていた部分が穴が開いた構 造が出来る。短い時間構造からコヒーレント放射を 効率良く放射することが出来、IR-THz 光源として 利用できる。

3.4.2 レーザーヒータ

FEL 施設において、マイクロバンチ不安定性と呼 ばれる現象によって性能が制限されることがある。 この現象は図 54 に説明するようなものである。電子 バンチの初期状態に僅かな密度分布があったとして、 それが空間電荷等の影響を介してバンチ内のエネル ギー変動を生み、さらに密度分布が成長していくと いうものである。結果的に、FEL の発振に重要なバ ンチ圧縮がうまく制御出来なくになってしまう。

これを解決する為、レーザーヒータと呼ばれる手 法が用いられる (図 55)。マイクロバンチ不安定性が 成長する前に、積極的にレーザーによって光の波長 でエネルギー変調をかける。これを分散によって前 後に引き延ばすことによって、密度分布を平坦化し て、マイクロバンチ不安定性の種を解消することが









図 53: レーザースライシング



図 54: マイクロバンチ不安定性



図 56: レーザーヒータによる密度分布の平坦化

出来る (図 56)。

3.4.3 光クライストロン

ところで、電磁波を使って電子ビームの密度に変 調をかける、というのは、マイクロ波の増幅器とし て良く知られているクライストロンと同じである。 図 57 にクライストロンの原理を簡単に示す。

レーザーとアンジュレータを使って、これと全く 同じ事が出来る (図 58)。入力 RF の代わりがレー ザーで、出力 RF の代わりがアンジュレータ放射で ある。1 台目のアンジュレータにおいて、入力した レーザー光で電子ビームにエネルギー変調を与え、 途中の分散部の R₅₆ (あるいはアンジュレータ自体 の分散)を経由して、これが密度変調に変換される。







図 58: 光クライストロンの原理

2 台目のアンジュレータには、入力レーザーと同じ 波長でプリバンチされた電子ビームが入力され、コ ヒーレントに放射が成長し、大きな出力を得る事が できる。これは、シード型 FEL の一種で、入力光と して高次高調波レーザーを用いる事で、短波長のフ ルコヒーレント FEL が実現できる。

3.4.4 HGHG

もともとの電子ビームのエネルギー広がりが小さ く、分散部が精密に調整されていると、サイン関数 状につけたエネルギー変調が立ち上がって、鋭い密 度変調が得られる事に成る。この場合、密度変調に 高次の成分 $n\omega$ も十分に含まれるので、2台目のアン ジュレータを $n\omega$ の共鳴条件に設計しておくと、対応 する波長でコヒーレント放射を起こすことが可能で ある (図 59)。これは、HGHG (High Gain Harmonic Generation) と呼ばれる。直接シードでは得られな い、より短波長のシード FEL を実現する、有効な手 法である。また、得られた高調波をを入力光として、 多段に HGHG を構成することで、より短波長のコ ヒーレント放射を実現することが可能である。

HGHG でどれだけ高い次数の高調波を生成できる







図 60: 分散部のアンジュレータにレーザーの斜め入 射の配置

かは、どれだけ鋭い密度変調を作る事ができるかで 決まる。もう少し凝った事を考えてピークを鋭くす る案も考えられている。アンジュレータ部に分散を 導入し、そこにレーザーを斜めに入力する (図 60)。 実効的にエネルギーによってレーザーの位相をずら す効果を与える事が出来る。すると、位相空間での 回転の中心位相がシフトし、丁度一致した位相でサ イン関数が立ち上がるように出来 (図 61)、非常に 鋭い密度分布が生成される (PEHG: Phase-merging Enhanced Harmonic Generation)。

3.4.5 EEHG

より細かな変調を作り出す手法として、変調を2 段階で行う手法もある (EEHG: Echo-Enebled Harmonic Generation)(図 62)。まず、1 段目のアンジュ レータでレーザーと相互作用させ、大きな振幅でサ イン波状のエネルギー変調を付ける。次の分散部で は、多数の横線が重なった状態 (横縞) になるまで大 きく引き延ばす。これを2 段目で変調すると、横縞



図 62: EEHG のレイアウト

全体にサイン波の変調を乗せる事が出来る。次の分 散部で適当なシフトをおこなうと、1 段目に作った 編構造が発現し、細かな密度変調が出来る。HGHG では到達出来ない程の次数の高調波成分を生成する ことが出来る (図 63)。

3.4.6 ESASE

レーザーによる密度変調の生成は、シード型 FEL に限らず、SASE-FEL の場合でも有用である。SASE の発振においては、ビームのピーク電流が重要であ るから、密度変調の効果で局所的にできた高電流部か ら SASE 発振がはじまることで、飽和に至る距離を 短く改善することが可能である。これは、Enhanced SASE と呼ばれる手法である。



図 63: EEHG の位相空間分布の発展



図 64: 高繰り返し ERL-FEL でのレーザー変調シス テム

3.4.7 高繰り返し FEL での検討

ここまで述べて来た、レーザーによるシード FEL の話は、低繰り返しの加速器で行われている。従っ て、高強度単一パルスのレーザーを使用すれば良く、 比較的簡単なもので良い。一方で、ERL は高繰り返 しの大平均電流であることが利点であるので、エネ ルギー変調システムを導入するとしたら、高繰り返 しに対応したものである必要がある。典型的に必要 とされるレーザーのパルスエネルギーは 100 µJ 程 度であるが、これを 100 MHz で供給するとすると、 10 kW もの平均パワーが必要になる。これは、最後 に述べる蓄積共振器の手法で実現する事が出来ると 考えられている。

式 269 より、アンジュレータの周期を $\lambda_u = 50$ mm、強さを K = 2 とすると、波長が $\lambda = 1 \mu m$ の レーザー光と共鳴するビームエネルギーは 140 MeV 程度になる。ERL の構成の FEL を検討する際に、線 型加速器を 2 段階に分けて、途中にエネルギー変調 器を入れる構成が考えられる (図 64)。エネルギーの 変調器と、そのあとに続くアークでの分散制御、主 加速部の加速位相、を組み合わせる事で、様々な応 用が可能になると考えられる。



図 65: コンプトン散乱



図 66: 電子静止系でのコンプトン散乱

3.5 コンプトン散乱

高エネルギー光子の光源として、レーザーを利用 したコンプトン散乱光源 (LCSS) が考えられる (図 65)。

3.5.1 散乱断面積

これまで、電子は非相対論的な量子力学と、相対 論的な古典力学で記述して来た。コンプトン散乱の 断面積を計算するには、相対論的な量子力学が必要 になるが、ここでは導出は省略し、結果だけ使用す ることにする。

電子の静止系での微分断面積は、クライン-仁科の 公式呼ばれるものがある。これを使うのが便利なの で、まず電子の静止系で、図 66 に示す散乱を考え る。質量 m の電子にエネルギー ω^* の光子が衝突し、 終状態では、エネルギー ω'^* の光子が角度 θ'^* の方 向に、電子は運動量 p'^* で角度 ϕ'^* の方向に散乱さ れる。



図 67: 電子静止系と実験室系

以降、電子の静止系の量は*をつけて、散乱後の 量は'をつけて表すことにする。

微分断面積は、

$$\frac{d\sigma}{d\Omega^*} = \frac{r_0^2}{2} \left(\frac{\omega'^*}{\omega^*}\right)^2 \left[\frac{\omega^*}{\omega'^*} + \frac{\omega'^*}{\omega^*} - 1 + \cos^2\theta'^*\right]$$
(285)

r₀は電子の古典半径である。

ここで、運動量の保存から、

$$\omega'^* = \frac{\omega^*}{1 + \frac{\omega^*}{m} (1 - \cos \theta'^*)}$$
(286)

の関係がある。ちなみに、入射光子エネルギーが電子 質量と比較して十分小さい時 ($\omega^* \ll m$)は、 $\omega'^* \sim \omega^*$ となり、入射光子と散乱光子のエネルギーは等し くなり、トムソン散乱と呼ばれる。

今、興味があるのは実験室系での量なので、ロー レンツ変換をする。 $\gamma = E/m$ 、 $\beta = -p/m$ である。 実験室系と電子静止系の関係を図 67 に示す。実験室 系では、電子ビームにたいして角度 θ で光子が入射 されるとした。

初期状態のローレンツ変換より、

$$\omega^* = \gamma \omega (1 - \beta \cos \theta) \tag{287}$$

$$\tan \theta^* = \frac{\sin \theta}{\gamma(-\beta + \cos \theta)} \tag{288}$$

の関係があることが分かる。 $\gamma \gg 1$ とすると、 $\theta^* \sim 0$ と近似して良い。 同様に終状態のローレンツ変換より、

$$\omega^{\prime *} = \omega^{\prime} \gamma (1 - \beta \cos \theta^{\prime}) \tag{289}$$

$$\cos\theta'^* = \frac{-\beta + \cos\theta'}{1 - \beta\cos\theta'} \tag{290}$$

の関係がある。

また、2つの系の立体角は、

$$\frac{d\Omega^*}{d\Omega} = \frac{1}{\gamma^2 (1 - \beta \cos \theta)^2} \tag{291}$$

の関係がある。

まとめると、実験室系での散乱の微分断面積は、

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d\sigma}{d\Omega^*} \frac{d\Omega^*}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \left(\frac{\omega'^*}{\omega^*}\right)^2 \left[\frac{\omega^*}{\omega'^*} + \frac{\omega'^*}{\omega^*} - 1 + \cos^2\theta'^*\right] \times \frac{1}{\gamma^2(1 - \beta\cos\theta)^2}$$
(292)

となる。表式が複雑になるので、電子静止系の量も 混ぜて書いているが、* 付きの量はローレンツ変換 に従って実験室系の量に置き換えれば良い。

最大エネルギーの光子が得られるのは、 $\theta' = \pi \sigma$ 、 ビーム軸上への散乱の場合で、

$$\omega_{max}' = \frac{2\gamma^2 \omega (1 - \beta \cos \theta)}{1 + 2\gamma \frac{\omega}{m} (1 - \beta \cos \theta)}$$
(293)

特に、入射光子が正面衝突 θ = 0 の場合、

$$\omega_{max}' = \frac{4\gamma^2 \omega}{1 + \frac{4\gamma\omega}{m}} \tag{294}$$

で、ビームエネルギーが比較的低く、 $\gamma \omega \ll m$ の時 は、 $\omega'_{max} \sim 4\gamma^2 \omega$ となり、入射光子がビームのエネ ルギーで~ γ^2 倍にブーストされて出てくる。このこ とから、比較的小型の加速器でエネルギーの高い光 子を生成できることが分かる。発散角は相対論的な 放射が大抵そうであるように、 $1/\gamma$ の広がりを持つ。

3.5.2 ルミノシティ

反応の頻度 (dY/dt) は、散乱断面積 σ とルミノシ ティ \mathcal{L} を用いて、

$$\frac{dY}{dt} = \sigma \mathcal{L} \tag{295}$$

である。



図 68: 収束点付近の電子ビームサイズ

ルミノシティは、ビームとレーザーの強度と衝突 の幾何学的な条件で決まる。ルミノシティを稼ぐ為 に、ビームもレーザーも衝突点で収束するように設 計される。

まず、電子ビームについて考える。ビームサイズ が、エミッタンス ϵ とベータ関数 β だけで決まる理 想的な場合を考える。

$$\sigma_e = \sqrt{\beta\epsilon} \tag{296}$$

ベータ関数の伝搬は、収束点での値 *β*w だけで決まり、

$$\beta(s) = \beta_w + \frac{s^2}{\beta_w} \tag{297}$$

に従う。図 68 のように、極小値が β_w 、そこから β_w だけ離れると 2 倍になるような具合である。

レーザーは、ガウスビームとして伝搬する。光子 密度分布の RMS サイズ σ_l と、電場強度の 1/e 半径 として定義した w は、

$$w = 2\sigma \tag{298}$$

の関係である。スポットサイズの伝搬は、図 69 のように、収束点でのサイズ w₀ だけで決まる。

$$w(z)^2 = w_0^2 \left(1 + \frac{z^2}{z_0^2}\right)$$
(299)

 z_0 はレイリー長で、 $z_0 = \pi w_0^2 / \lambda$ である。つまり、 レーザー RMS サイズの伝搬は、

$$\sigma_l(z) = \frac{w_0}{2} \sqrt{1 + \frac{\lambda^2 z^2}{\pi^2 w_0^4}}$$
(300)



図 69: 収束点付近のレーザーサイズ

である。

時間に依存した 3 次元的な電子ビームプロファイ ル $D_B(x_B, y_B, z_B, t)$ を次のように記述する。座標軸 を x_B, y_B, z_B と表し、 z_B がビームの進行方向である。 t は時間。

$$D_B = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{B_x}} \exp\left(\frac{-x_B^2}{2\sigma_{B_x}^2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{B_y}} \exp\left(\frac{-y_B^2}{2\sigma_{B_y}^2}\right)$$
$$\cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{B_z}} \exp\left(\frac{-(z_B - ct)^2}{2\sigma_{B_z}^2}\right) \tag{301}$$

 $\sigma_{B_x}, \sigma_{B_y}$ は、x, y方向のビームサイズで、 z_B に依存 する。 σ_{B_z} はバンチ長である。

同様に、レーザーのプロファイル $D_L(x_L, y_L, z_L, t)$ は、座標軸を x_L, y_L, z_L 、 z_L がビームの進行方向として、

$$D_L = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{L_x}}} \exp\left(\frac{-x_L^2}{2\sigma_{L_x}^2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{L_y}}} \exp\left(\frac{-y_L^2}{2\sigma_{L_y}^2}\right)$$
$$\cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{L_z}}} \exp\left(\frac{-(z_L - ct)^2}{2\sigma_{L_z}^2}\right)$$
(302)

 $\sigma_{L_x}, \sigma_{L_y}$ は、x, y方向のビームサイズで、 z_L に依存 する。 σ_{L_x} はパルス長である。

図70のように、ビームとレーザーが衝突角 θ の配 置とすると、それぞれの座標軸を次のように考えれ ば良い。

$$(x_B, y_B, z_B) = (x, y, z)$$
 (303)

$$(x_L, y_L, z_L) = (x \cos \theta - z \sin \theta, y, -x \sin \theta - z \cos \theta)$$
(304)



図 70: 電子ビームとレーザーの衝突角

ルミノシティんは、これらを積分して得られる。

$$\mathcal{L} \propto \int_{x} \int_{y} \int_{z} \int_{t} D_{B} \cdot D_{L} dx dy dz dt \qquad (305)$$

3.5.3 蓄積共振器

光源として検討すると、やはりフラックスが重要 になってくる。そのためには、平均強度の大きなレー ザー光が必要である。エネルギーの保存から明らか なように、レーザー光源を励起するエネルギー (例 えば数 100 W の LD) 以上のレーザー光を生成する ことは不可能である。そこで、共振器を使って、光 を蓄積し実効的に大きな平均強度を実現することが 考えられる。

共振器は、鏡などを使って構成した閉じた光路で ある。この中のレーザー光は共振器内部を周回する ため、共振器内部で電子ビームとの衝突を行えば、 レーザー光を何度も衝突に再利用することができる (図1)。ルミノシティを稼ぐにはレーザー光を収束す ることが重要であるが、最も単純な2枚鏡の共振器 では安定性が良くない。そこで、図71のような4枚 鏡共振器が良く使われる。収束条件は凹面鏡で制御 し、周長は独立に平面鏡で制御することができる。

発振器について議論した際には、共振器の内部に 光増幅器が設置されたが、ここでは空の共振器に外 からレーザー光を入力し、光を蓄積すること考える。 簡単のため、2枚鏡共振器で議論する。誘電体多層 膜の共振器鏡で、2枚とも反射率が*R*、透過率が*T* の場合を考える。ここの外部からレーザー光を入力 するが、普通に考えると、入口の鏡でほぼ反射され



図 71: 収束点を持つ4枚鏡共振器

て、共振器の中には入って行かないように思える。た だし、共鳴条件(共振器内部で定在波が立つ条件)で は、共振器としての反射率が下がり、内部にパワー が入って行く。これは、加速器でおなじみのマイク ロ波空洞と同じである。

振幅足し合わせを考えれば、共振器としての動作 が理解できる。鏡の振幅反射率 r と透過率 t は、

$$= \sqrt{R} \tag{306}$$

$$=\sqrt{T}$$
 (307)

である。図72に概念的に示すように、振幅1で入射 した光は、各共振器鏡で反射と透過の振幅に分けら れ、振幅として重ね合わされる。共振器としての反 射振幅 r_{cav} と透過振幅 t_{cav}、内部の片道の振幅 s_{cav} は、

$$r_{cav} = r + trte^{i\phi} + trrrte^{i2\phi} + \cdots \quad (308)$$

$$t_{cav} = tt + trrte^{i\phi} + trrrrte^{i2\phi} + \cdots (309)$$

$$s_{cav} = t + trre^{i\phi} + trrrre^{i2\phi} + \cdots \quad (310)$$

となる。 ϕ は共振器の周長に対応した一周での位相 の進みである。共振器としての反射率 R_{cav} 、透過 率 T_{cav} 、蓄積強度(片道) S_{cav} は、振幅を自乗して得 られ、

$$R_{cav} = R + T - \frac{T(1 - R^2 - TR)}{(1 - R)^2 + 4R\sin^2(\frac{\phi}{2})} (311)$$

$$T^2 = T^2 = (11)^2 + C^2 +$$

$$T_{cav} = \frac{1}{(1-R)^2 + 4R\sin^2(\frac{\phi}{2})}$$
(312)

$$S_{cav} = \frac{T_{cav}}{T} \tag{313}$$

となる。周回位相、つまり共振器の周長を波長で割ったもの、と蓄積強度の関係を図 73 に示す。共鳴条件



図 72: 共振器内の振幅の重ね合わせ

が成立するときに、共振器内部にレーザー光が蓄積 されることが分かる。蓄積される強度は、共振器鏡 の反射率が大きい (つまり共振器の損失が小さい) ほ ど大きくなる。ただし、反射率の高い共振器鏡を用 いると、共鳴幅が狭くなることが分かる。

多数の鏡からなる共振器で、それぞれの鏡の反射 率を R_1, R_2, R_3, \cdots とした場合、実効的は反射率 (あ るいは周回効率) なるものは $R_{eff} = \sqrt{R_1 R_2 R_3 \cdots}$ となる。フィネス F と呼ぶ量を、

$$F = \frac{\pi \sqrt{R_{eff}}}{1 - R_{eff}} \tag{314}$$

と定義すると、共鳴幅は波長にたいして~1/Fの関係になる。

共鳴条件を制御するには、共振器の長さを制御す るか、レーザー光の波長を制御する必要がある。具 体的には、蓄積共振器あるいはレーザー発振器の共 振器を構成する鏡を機械的にピエゾで駆動するよう にし、共振器長をフィードバック制御する。より高 速な制御が必要になった場合は、レーザー発振器内 に位相変調器を導入し、電気的な制御を行うことも 考えられる。高フィネスになると、外乱や波長のふ らつきの影響を受け、共鳴を維持するのが技術的に 難しくなってくる。

超高フィネスになった場合、人為的なフィードバッ ク制御による共鳴維持が難しくなってくる。そこで、 光そのものに働いてもらうという図 74 のような案 がある。独立なレーザー発振器を使用せずに、蓄積 共振器と高ゲインの増幅器を一体にしたシステムで



図 73: 周回位相と共振器内強度



図 74: 発振型の構成

ある。発振は増幅器の自然放出光のノイズを種とし て始まる。自然放出光が共振器に入力され、そのう ち共振器の共鳴条件を満たした成分だけが蓄積され る。共振器の透過光は、共振器で共鳴したものが漏 れて出て来ているものであるから、必ず共振器の共 鳴条件を満たしたものである。これを増幅し、再び 入力光として利用することで、常に共鳴条件に合っ た光が入力されるようになる。これが帰還的におこ り、定常状態では、周回の損失と増幅器のゲインが バランスする状態で、自動的に共振器の共鳴が維持 されることになる。

ここまでの議論は、単一周波数の CW レーザーを 念頭に行って来た。モードロックパルスレーザーの 場合はどうなるか考えてみる。図 75 上に示すよう に、モードロックレーザーは、パルス繰り返しの周



図 75: モードロックレーザーの蓄積

波数間隔 F_{rep} の多縦モードのレーザーである。縦 モードの一つ一つは CW レーザーと変わらない。図 73 で見たように、共振器の共鳴ピークも有限の共鳴 幅を持った多数の縦モード構造である。周波数軸で 書くと、図 75 下のように共振器の基本周波数 F_{cav} 間隔に共鳴線があることになる。これに、入力する モードロックレーザーの多数の縦モードを重ねて見 て、共振器の共鳴幅に受け入れられたものが蓄積出 来る事になる。発振器と共振器の絶対長が合ってい る、つまり F_{rep} と F_{cav} が一致していると、全ての 縦モードを受け入れる事ができ、パルスでの蓄積が できることになる。(少しずれていると、一部のモー ドしか共鳴条件を満たせず、効率が落ちるし、パル ス長が伸びる。)

より短パルスレーザー (より多数の縦モード)で、 より高フィネスの共振器に蓄積しようとすると、パル ス内位相 (CEP: キャリアエンベロープ位相)の影響 も考えなければならない。図 76 に示すように、モー ドロックレーザーの各パルス内部の電場波形の位相 は、発振器の分散関係に起因して、シフトしていく 場合がある。これは、図 75 上に示すように、周波数 軸で縦モード構造の見た時の起点となるオフセット 周波数 (CEO:キャリアエンベロープオフセット と呼 ぶ)と関係するものである。有限の CEO があると、 パルス間の位相が重ならず、蓄積効率が低下してし まう。



図 76: キャリアエンベロープ位相

3.5.4 LCSS の利用

LCSS は、とくに γ 線領域の高エネルギーで、単色 で偏光を制御できる光源としてほぼ唯一の方式であ ろう。目先の予算の獲得ができそうな産業、医学な どの応用研究だけにとどまらず、基礎科学での利用 が期待出来ることを忘れてはならない。アクシオン 探索や真空複屈折の観測、リニアコライダーにおけ る偏極陽電子源、γγ コライダーによるヒッグスファ クトリ、など、LCSS があって初めて可能になる実 験が考えられている。

4 おわりに

KEK では、ERL 試験加速器である cERL が建設 され、ビームコミッショニングを行っているところで ある。エネルギー回収しながら、連続運転でビーム が周回するようになり、なんとかはじまりのおわり くらいまで来た、あるいはこれからようやく本格的 なビーム運転の始まり、といったところである。思 えば、KEK で最初の ERL 専任として仕事を初めて 以来、今となっては人もかなり増えて一つの加速器 の運転が出来るまでになった。果たしてこれから、 試験加速器の成果を踏まえて本格的な実機の開発に 発展して行くのであろうか、はたまたここを潮時に 縮小に転じるのであろうか。いずれにしても、これ から数年は ERL をめぐる動向からは目が離せない 時期であろう。

そもそも、レーザーの専門という訳でもないが、余 計な事に手を出すのにさして抵抗を感じない性格の ためか、所外の某研究所に任せていた電子銃のレー ザーの開発がいよいよ cERL の建設に間に合わない となったところで、首を突っ込んでしまったばっかり に、いつの間にか電子銃レーザー担当みたいな立場 に置かれてしまった。ひとたび電子銃レーザーの人 と見られてしまうと、いつでもその話を期待される ようになってしまうし、それ以外の議論の際には除 外されてしまうことさえある。今回はきっと、cERL の電子銃レーザーシステムの解説を期待されたよう な気もするが、あえてそこは避けて通ってみた。今 後の ERL などの光源加速器の展開を考えると、レー ザーの開発にもっと力を入れる必要があるし、レー ザーだけでなく加速器全体を見据えた設計検討が必 要であることを示したつもりである。

謝辞

本稿の執筆にあたって、赤木智哉氏と小菅淳氏に 査読コメントをいただいた。この場を借りて感謝い たします。

なお、本研究の一部は、光 · 量子融合連携研究開 発プログラムによるものである。

参考文献

- [1] ラング, "線形代数学", ちくま学芸文庫
- [2] ファインマン他, "ファインマン物理学 V", 岩波書店
- [3] キッテル,"熱物理学", 丸善
- [4] Amnon Yariv, "光エレクトロニクス", 丸善
- [5] Siegman, "LASER", University Science Books
- [6] キッテル、"固体物理学入門"、 丸善
- [7] U. Keller *et al.*, "Semiconductor Saturable Absorber Mirrors (SESAM's) for Femtosecond to Nanosecond Pulse Generation in Solid-State Lasers", IEEE J. of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 2, No. 3 (1996) p435

- [8] Z.F.Li *et al.*, "Multiple-harmonic generation in rare gases at high laser intensity", Phys. Rev. A, 39, 5751 (1989)
- [9] P. Hartmann *et al.*, "A diffusion model for picosecond electron bunches from negative electron affinity GaAs photocathodes", Journal of Applied Physics, Vol. 86, 4 (1999) p2245
- [10] Z. Liu *et al.*, "Narrow cone emission from negative electron affinity photocathodes", J. Vac. Sci. Technol. B, 23 (6) (2005) p2758
- M. O. Scully *et al.*, "Simple laser accelerator: Optics and particle dynamics", Phys. Rev. A, Vol. 44, pp2656 (1991)
- [12] 本田洋介, "高繰り返しシード型自由電子レー ザーのためのレーザーエネルギー変調器",
 第 11 回加速器学会 (2014)
- [13] 亀井亨, 木原元央, "加速器科学 (パリティ物理 学コース)", 丸善
- [14] R.W. Schoenlein *et al.*, "Generation of femtosecond X-ray pulses via laser-electron beam interaction", App. Phys. B 71 1-10 (2000)
- [15] M. Shimada *et al.*, "Intense Terahertz Synchrotron Radiation by Laser Bunch Slicing at UVSOR-II Electron Storage Ring", Jpn. J. App. Phys. Vol. 46, No.12, (2007) p7939
- [16] Z.Huang *et al.*, "Measurements of the linac coherent light source laser heater and its impact on the x-ray free-electron laser performance", Phys. Rev. ST-AB, 13, 020703 (2010)
- [17] 稲垣隆宏,"大電力高周波源", OHO13
- [18] H. Tomizawa *et al.*, "Stable Operation of HHG-Seeded EUV-FEL at the SCSS Test Accelerator", Proc. of FEL2013, New York, thoano01 (2013)

- [19] L. H. Yu *et al.*, "First Ultraviolet High-Gain Harmonic-Generation Free-Electron Laser", New Journal of Physics 16 (2014) 043021
- [20] H. Deng et al., "Using Off-Resonance Laser Modulation for Beam-Energy-Spread Cooling in Generation of Short-Wavelength Radiation", Phys. Rev. Lett., 111,084801 (2013)
- [21] C. Feng *et al.*, "Three-dimensional manipulation of electron beam phase space for seeding soft x-ray free-electron lasers", Phys. Rev. ST-AB, 17,070701 (2014)
- [22] G. Stupakov, "Using the Beam-Echo Effect for Generation of Short-Wavelength Radiation", Phys. Rev. Lett, 102,074801 (2009)
- [23] A. A. Zholents *et al.*, "Current-Enhanced SASE using an Optical Laser and its Application to the LCLS", SLAC-PUB-10713 (2004)
- [24] 本田洋介他,"発振型光蓄積装置の開発",第 7回加速器学会 (2010)
- [25] 本田洋介,"将来光源加速器による新粒子の探索", 第11回加速器学会 (2014)
- [26] T. Omori *et al.*, "Conceptual Design of a Polarized Positron Source Based on Laser Compton Scattering", KEK Preprint 2005-60
- [27] T. Akagi *et al.*, "Development of a three dimensional four mirror optical cavity for laser-Compton scattering", Nucl. Instr. Meth. A 724 (2013) 63-79
- [28] S.A. Bogacz et al., "SAPPHiRE: a Small Gamma-Gamma Higgs Factory", arXiv:1208.2827v1 [physics.acc-ph]